



OptiMOS™ および StrongIRFET™ MOSFET セレクションガイド 2019

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V



目次

OptiMOS™ および StrongIRFET™	3
MOSFET N チャネルパワー MOSFET 20~300 V	3
技術開発と製品ファミリーの位置付け	4
アプリケーションと耐圧クラスの対応について	5
スペース節減と高性能パッケージ	6
ディスクリートおよび統合パッケージ	7
OptiMOS™ および StrongIRFET™ 製品ポートフォリオ	8
OptiMOS™ の製品番号について	27
StrongIRFET™ の製品番号について	28



OptiMOS™ および StrongIRFET™

MOSFET N チャネルパワー MOSFET 20~300 V

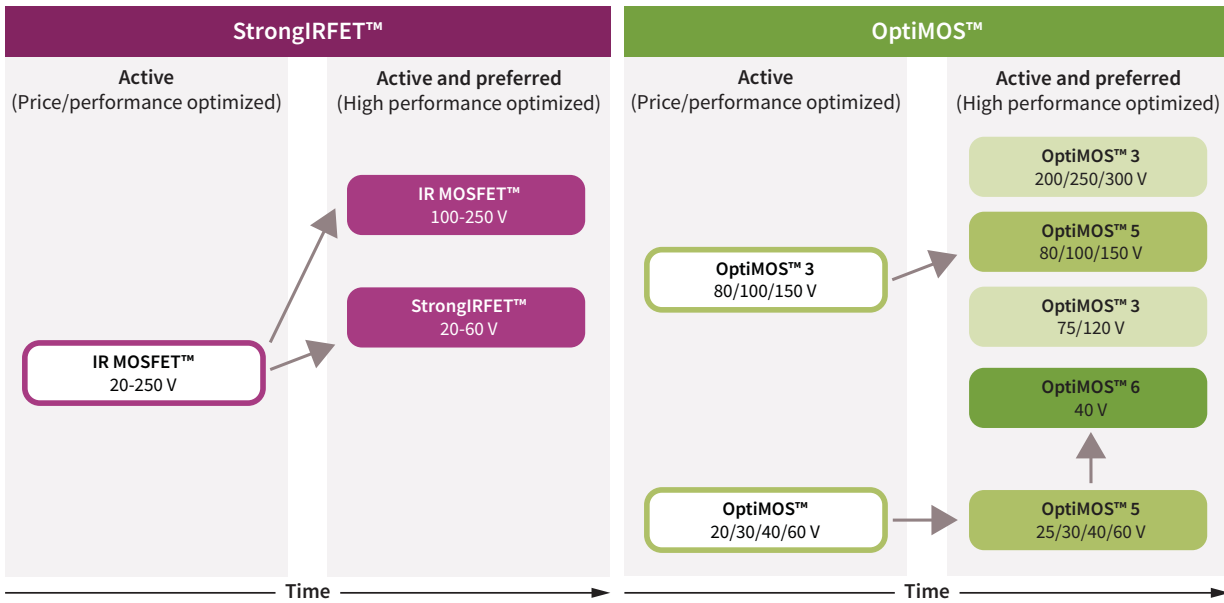
インフィニオンの半導体は、エネルギー効率、電力密度、費用対効果を高める点を特長としています。幅広い OptiMOS™ および StrongIRFET™ パワー MOSFET 製品は、スイッチモード電源 (SMPS)、バッテリー駆動アプリケーション、モータ制御 (駆動)、インバータ、コンピューティングなどのアプリケーションで革新性と優れた性能を実現します。

インフィニオンの革新的な OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーは、オン抵抗 ($R_{DS(on)}$) や性能指数特性 (FOM) など、電力システム設計の重要な仕様について、最高の品質と性能に対する要求を満たします。

OptiMOS™ パワー MOSFET は、卓越したクラス最高の性能を実現します。高スイッチング周波数アプリケーション向けの超低オン抵抗 ($R_{DS(on)}$) および低電荷を特長としています。StrongIRFET™ パワー MOSFET は、駆動アプリケーション向けに設計されており、低スイッチング周波数または大電流許容能力を必要とする設計に最適です。

StrongIRFET™	OptiMOS™
堅牢性と優れた価格性能比	クラス最高の技術
産業アプリケーション向けの設計	高性能アプリケーション向けの設計
低周波スイッチングに最適	高周波スイッチングに最適
大電流許容能力	業界最高の FOM (性能指数)
堅牢なシリコン	高効率と高電力密度
	

技術開発と製品ファミリーの位置付け



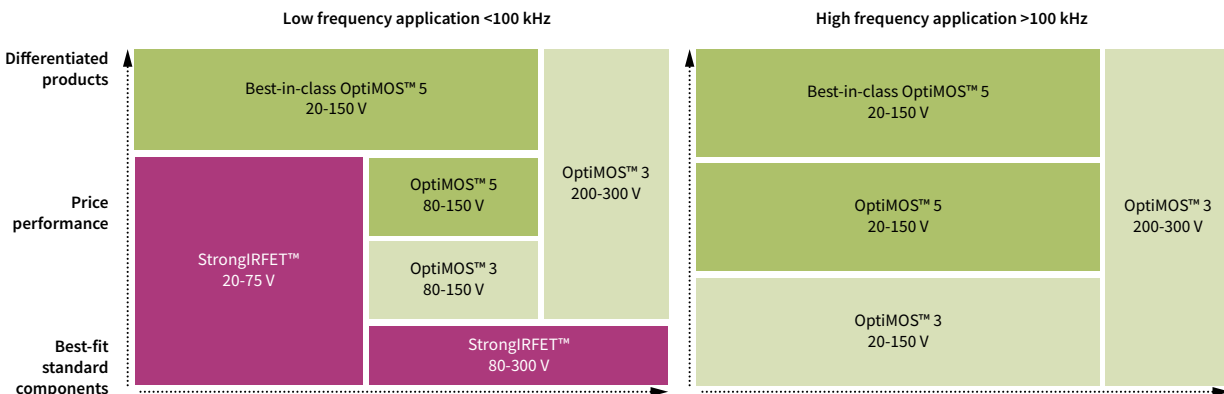
インフィニオンのパワー MOSFET 20~300 V 製品ポートフォリオは、クラス最高の性能を発揮する利用可能な最新の技術「アクティブ & 推奨品」および幅広いポートフォリオを補完する確立された技術で構成される「アクティブ」に分類されます。

OptiMOS™6 パワー MOSFET 40V は、SuperSO 8 または PQFN 3.3 x 3.3 パッケージで入手可能な OptiMOS™ 製品ファミリーの最新製品です。この技術は、クラス最高の製品と幅広い出力電力にわたって高効率が必要な場合に最適なソリューションです。OptiMOS™ 5 は 25V~150V 耐圧クラス市場における最新世代でクラス最高の性能および価格性能比のソリューションを提供します。

高周波スイッチングアプリケーションでは、標準コンポーネントとして OptiMOS™ 3 パワー MOSFET 40~50 V で製品ポートフォリオが補完されます。「アクティブ & 推奨品」OptiMOS™ 3 パワー MOSFET 75~120 V および 200~300 V は、低スイッチング周波数または高スイッチング周波数のアプリケーションに最適なポートフォリオです。幅広い製品でクラス最高の性能から標準製品までカバーしています。

StrongIRFET™ Gen. 1 は、クラス最高性能が不可欠ではなく、コストをより重視する場合に 20~300V のアプリケーションに適しています。

下の図は、スイッチング周波数ごとに、ベーシックな標準品、価格性能比のバランスのとれた製品、および差別化製品の推奨技術を示しています。



アプリケーションと耐圧クラスの対応について

MOSFET 20V~300V をカバーする OptiMOS™ および StrongIRFET™ ポートフォリオは、低スイッチング周波数から高スイッチング周波数まで幅広いニーズに対応できます。下の表は、主なサブアプリケーションと耐圧クラスごとに推奨する OptiMOS™ 製品または StrongIRFET™ 製品の対応について示しています。

推奨電圧		20~30 V	40 V	60 V	75~80 V	100 V	135~150 V	200 V	250 V	300 V	
バッテリー駆動	低電力 高動工具、マルチコ ンピューター（パソコン）、バ ッテリー、産業向けモ ーター駆動	OptiMOS™	✓	✓	✓	✓					
		StrongIRFET™	✓	✓	✓	✓					
	高電力 (LEV、LSEV)	OptiMOS™			✓	✓	✓	✓	✓		
		StrongIRFET™			✓	✓	✓	✓	✓		
インバータ	太陽光発電	OptiMOS™			✓	✓	✓	✓			
		StrongIRFET™			✓	✓	✓				
	UPS	低速スイッチング									
		OptiMOS™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		StrongIRFET™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		高速スイッチング									
		OptiMOS™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		StrongIRFET™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
オフライン	OptiMOS™		✓	✓							
	StrongIRFET™		✓	✓							
SMPS	アダプタ/ 充電器	OptiMOS™		✓	✓	✓	✓				
		StrongIRFET™		✓	✓	✓	✓				
	PC電源	OptiMOS™		✓	✓						
		StrongIRFET™		✓	✓						
	LCD テレビ	OptiMOS™			✓	✓	✓				
		StrongIRFET™			✓	✓	✓				
	サーバー	OptiMOS™		✓	✓	✓					
		StrongIRFET™		✓	✓	✓					
	AC-DC	OptiMOS™				✓	✓	✓	✓		
		StrongIRFET™				✓	✓				
	通信システム	OptiMOS™	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		StrongIRFET™	✓	✓	✓	✓	✓				






StrongIRFET™ 推奨品






OptiMOS™ 推奨品

StrongIRFET™ 供給中

OptiMOS™ 供給中

スペース節減と高性能パッケージ

	TO-247	TO-220	D ² PAK	D ² PAK 7ピン	TO リードレス
					
	高電力アプリケーションおよび大電流許容能力に最適				
高さ [mm]	5.0	4.4	4.4	4.4	2.3
外形 [mm]	40.15 x 15.9	29.5 x 10.0	15.0 x 10.0	15.0 x 10.0	11.68 x 9.9
電流許容能力 [A]	195.0	195.0	195.0	240.0	300.0
間熱抵抗 R _{thJC} [K/W]	2.0	0.5	0.5	0.5	0.4

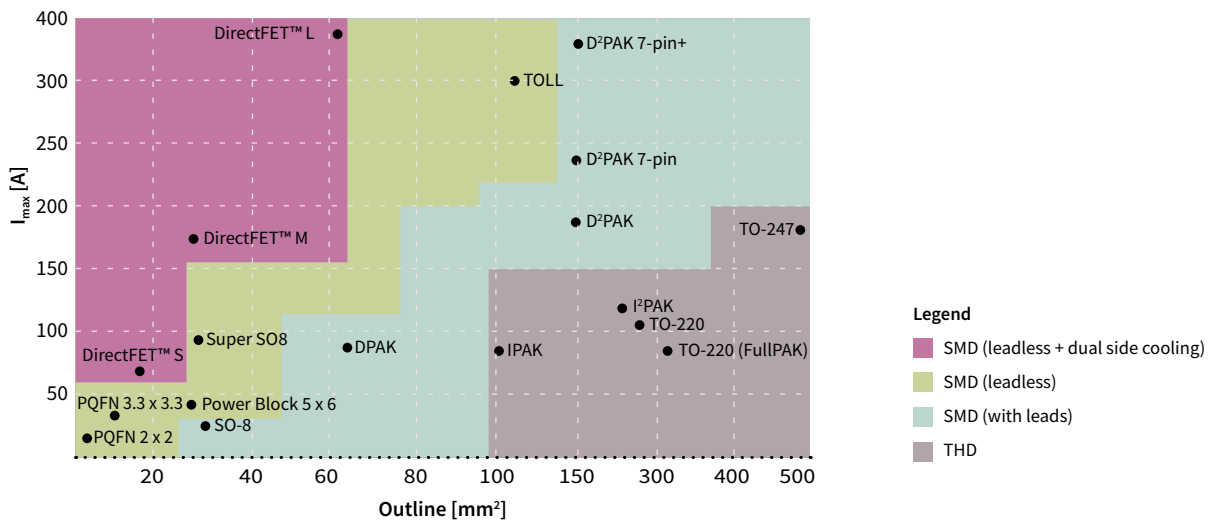
	SuperSO8	Power Block	PQFN 3.3 x 3.3	PQFN 2 x 2	DirectFET™
					
	きわめて高い効率とパワーマネジメント向け	大幅な設計サイズ縮小	きわめて高い効率とパワーマネジメント向け	大幅なスペース削減を実現	小さなフットプリントで極めて良好な熱特性
高さ [mm]	1.0	1.0	1.0	0.9	小:0.65 中:0.65 大:0.71
外形 [mm]	5.15 x 6.15	5.0 x 6.0	3.3 x 3.3	2.0 x 2.0	小:4.8 x 3.8 中:6.3 x 4.9 大:9.1 x 6.98
電流許容能力 [A]	100.0	50.0	40.0	18.5	小:75.0 中:180.0 大:375.0
間熱抵抗 R _{thJC} [K/W]	0.8	1.5	3.2	11.1	0.5

ディスクリートおよび統合パッケージ

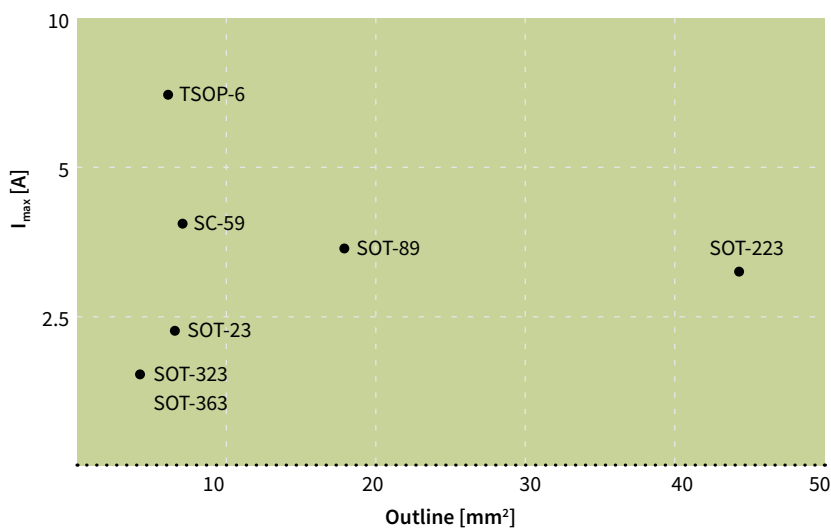
OptiMOS™ および StrongIRFET™ 技術は、大電流許容能力および大幅なスペース削減の要求に応えるために、さまざまなパッケージで提供されています。

幅広いポートフォリオにより、実装面積の削減、電流定格の増大および熱特性の最適化を実現しています。表面実装リードレスデバイスがフットプリントの低減を実現します。スルーホールパッケージは高電力定格を特長としています。

インフィニオンは、DirectFET™ および TO リードレスなどの革新的なパッケージも提供しています。DirectFET™ は、寄生抵抗が極めて低く、高周波スイッチングアプリケーションに最適です。このパッケージには、小、中、大の 3 種類のサイズがあります。TO リードレスは最大 300A の電流容量で、実装面積を大幅に削減して電力密度を高めることができます。



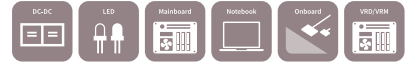
小信号および小電力 MOSFET



小信号および小電力 MOSFET については、大型の SOT-223 から最小の SOT-363 まで全 8 種類の業界標準パッケージを提供しています。

製品はシングル構成、デュアル構成およびコンプリメンタリ構成で提供され、バッテリー保護、LED照明、低電圧ドライブ、DC-DC コンバータなどの幅広いアプリケーションに適しています。

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 20 V (スーパー) ロジックレベル



R _{DS(on)} 最大 @ V _{GS} =10 V [mΩ]	TO-252 (DPAK)	DirectFET™	PQFN 2 x 2	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8	SOT-23
< 1		IRL6283MTRPBF R _{DS(on)} =0.65 mΩ			IRFH6200TRPBF R _{DS(on)} =0.99 mΩ		
2~4	IRLR6225TRPBF R _{DS(on)} =4.0 mΩ	IRL6297SDTRPBF** R _{DS(on)} =3.8 mΩ; デュアル			BSC026N02KS G R _{DS(on)} =2.6 mΩ IRLH6224TRPBF R _{DS(on)} =3.0 mΩ	IRF6201TRPBF R _{DS(on)} =2.45 mΩ	
4~10					BSC046N02KS G R _{DS(on)} =4.6 mΩ	IRF3717 R _{DS(on)} =4.4 mΩ	
> 10			IRLHS6242TRPBF R _{DS(on)} =11.7 mΩ IRLHS6276TRPBF** R _{DS(on)} =45.0 mΩ; デュアル				IRLML6244 1) *** R _{DS(on)} =21 mΩ IRLML6246 1) *** R _{DS(on)} =46 mΩ

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 25 V ロジックレベル



R _{DS(on)} 最大 @ V _{GS} =10 V [mΩ]	DirectFET™	PQFN 2 x 2	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8	SOT-23
< 1	IRF6718L2TRPBF R _{DS(on)} =0.7 mΩ BSB008NE2LX R _{DS(on)} =0.8 mΩ		BSZ009NE2LS5 ²⁾ R _{DS(on)} =0.9 mΩ	BSC009NE2LS R _{DS(on)} =0.9 mΩ BSC009NE2LS5 R _{DS(on)} =0.9 mΩ BSC009NE2LS5I** R _{DS(on)} =0.95 mΩ		
1~2	IRF6898MTRPBF** R _{DS(on)} =1.1 mΩ BSB012NE2LXI** R _{DS(on)} =1.2 mΩ IRF6717MTRPBF R _{DS(on)} =1.25 mΩ IRF6894MTRPBF** R _{DS(on)} =1.3 mΩ BSB013NE2LXI** R _{DS(on)} =1.3 mΩ IRF6797MTRPBF** R _{DS(on)} =1.4 mΩ IRF6716M R _{DS(on)} =1.6 mΩ IRF6715MTRPBF R _{DS(on)} =1.6 mΩ IRF6893MTRPBF** R _{DS(on)} =1.6 mΩ IRF6892STRPBF** R _{DS(on)} =1.7 mΩ IRF6795MTRPBF** R _{DS(on)} =1.8 mΩ		BSZ010NE2LS5 ²⁾ R _{DS(on)} =1.0 mΩ BSZ011NE2LS5 ²⁾ R _{DS(on)} =1.1 mΩ BSZ013NE2LS5I** R _{DS(on)} =1.3 mΩ BSZ014NE2LS5IF *** R _{DS(on)} =1.45 mΩ BSZ017NE2LS5I** R _{DS(on)} =1.7 mΩ BSZ018NE2LS R _{DS(on)} =1.8 mΩ BSZ018NE2LSI** R _{DS(on)} =1.8 mΩ	BSC010NE2LS R _{DS(on)} =1.0 mΩ BSC010NE2LSI** R _{DS(on)} =1.05 mΩ BSC014NE2LSI** R _{DS(on)} =1.4 mΩ IRFH5250D R _{DS(on)} =1.4 mΩ BSC015NE2LS5I** R _{DS(on)} =1.5 mΩ BSC018NE2LS R _{DS(on)} =1.8 mΩ BSC018NE2LSI** R _{DS(on)} =1.8 mΩ		
2~4	IRF6714MTRPBF R _{DS(on)} =2.1 mΩ BSF030NE2LQ R _{DS(on)} =3.0 mΩ BSF035NE2LQ R _{DS(on)} =3.5 mΩ IRF6811STRPBF** R _{DS(on)} =3.7 mΩ		BSZ031NE2LS5 R _{DS(on)} =3.1 mΩ BSZ033NE2LS5 R _{DS(on)} =3.3 mΩ BSZ036NE2LS R _{DS(on)} =3.6 mΩ BSZ037NE2LS5 ²⁾ RDS(on)= 3.7mΩ BSZ039NE2LS5 ²⁾ R _{DS(on)} = 3.9 mΩ	BSC024NE2LS R _{DS(on)} =2.4 mΩ BSC026NE2LS5 R _{DS(on)} =2.6 mΩ BSC032NE2LS R _{DS(on)} =3.2 mΩ	IRF8252 R _{DS(on)} =2.7 mΩ	
4~10	IRF6802SD R _{DS(on)} =4.2 mΩ IRF6710S2TRPBF R _{DS(on)} =4.5 mΩ IRF6712STRPBF R _{DS(on)} =4.9 mΩ IRF6810STRPBF** R _{DS(on)} =5.2 mΩ		IRFHM8228TRPBF R _{DS(on)} =5.2 mΩ BSZ060NE2LS R _{DS(on)} =6.0 mΩ IRFHM8235TRPBF R _{DS(on)} =7.7 mΩ	BSC050NE2LS R _{DS(on)} =5.0 mΩ		
> 10		IRFHS8242 R _{DS(on)} =13 mΩ				IRFML8244 R _{DS(on)} =24 mΩ

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

* 共振アプリケーションに最適化 (例: LLC コンバータ)

** モノリシック集積類似ショットキーダイオード

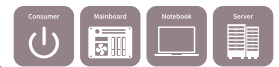
*** R_{DS(on)} 最大 @ V_{GS} = 4.5 V

1) 2.5 V_{GS} 可能

2) 近日発売

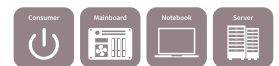


OptiMOS™ および StrongIRFET™ 25 V/30 V パワーステージ 3 x 3 および 5 x 6



部品番号	パッケージ	モノリシック 集積類似ショットキーダイオード	BVDSS [V]	R _{DS(on),最大} [mΩ] @ V _{GS} =4.5 V 最大		Q _g [nC] @ V _{GS} =4.5 V 標準	
				高電圧	低電圧	高電圧	低電圧
BSZ0910ND	TISON 3 x 3	-	30	13	13	4.0	4.0
BSZ0909ND	TISON 3 x 3	-	30	25	25	1.8	1.8
BSC0910NDI	TISON 5 x 6	ü	25	5.9	1.6	7.7	25.0
BSC0911ND	TISON 5 x 6	-	25	4.8	1.7	7.7	25.0
BSC0921NDI	TISON 5 x 6	ü	30	7.0	2.1	5.8	21.0
BSC0923NDI	TISON 5 x 6	ü	30	7.0	3.7	5.2	12.2
BSC0924NDI	TISON 5 x 6	ü	30	7.0	5.2	5.2	8.6
BSC0925ND	TISON 5 x 6	-	30	6.4	6.4	5.2	6.7

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 25V/30V パワーブロック 5 x 6 および 5 x 4



部品番号	パッケージ	モノリシック 集積類似ショットキーダイオード	BVDSS [V]	R _{DS(on),最大} [mΩ] @ V _{GS} =4.5 V 最大		Q _g [nC] @ V _{GS} =4.5 V 標準	
				高電圧	低電圧	高電圧	低電圧
BSG0810NDI	TISON 5 x 6	ü	25	4.0	1.2	5.6	16.0
BSG0811ND	TISON 5 x 6	-	25	4.0	1.1	5.6	20.0
BSG0813NDI	TISON 5 x 6	ü	25	4.0	1.7	5.6	12.0
IRFH4257DTRPBF	PQFN 5 x 4	ü	25	4.7	1.8	9.7	23.0

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 30 V ロジックレベル



$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7ピン)	TO-220
<1			IPB009N03L G $R_{DS(on)}=0.95\text{ m}\Omega$	
1~2		IRLS3813TRLPBF $R_{DS(on)}=1.95\text{ m}\Omega$		IRLB3813PBF $R_{DS(on)}=1.95\text{ m}\Omega$
2~4	IRLR8743TRPBF $R_{DS(on)}=3.1\text{ m}\Omega$			IRLB8314PBF $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$
	IPD031N03L G $R_{DS(on)}=3.1\text{ m}\Omega$			IRL3713PBF $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$
		IPB034N03L G $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$		IRLB8743PBF $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$
4~10	IPD040N03L G $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$			IPP034N03L G $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$
	IPD050N03L G $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$	IPB042N03L G $R_{DS(on)}=4.2\text{ m}\Omega$		IPP042N03L G $R_{DS(on)}=4.2\text{ m}\Omega$
	IRLR8726TRPBF $R_{DS(on)}=5.8\text{ m}\Omega$	IPB055N03L G $R_{DS(on)}=5.5\text{ m}\Omega$		IRLB8748PBF $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$
	IPD060N03L G $R_{DS(on)}=6.0\text{ m}\Omega$	IPB065N03L G $R_{DS(on)}=6.5\text{ m}\Omega$		IPP055N03L G $R_{DS(on)}=5.5\text{ m}\Omega$
	IPD075N03L G $R_{DS(on)}=7.5\text{ m}\Omega$	IPB080N03L G $R_{DS(on)}=8.0\text{ m}\Omega$		IRL8113PBF $R_{DS(on)}=6.0\text{ m}\Omega$
	IRLR8729TRPBF $R_{DS(on)}=8.9\text{ m}\Omega$			IRLB8721PBF $R_{DS(on)}=8.7\text{ m}\Omega$
	IPD090N03L G $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$			
	IPD135N03L G $R_{DS(on)}=13.5\text{ m}\Omega$			
10~25	IRLR3103 $R_{DS(on)}=19.0\text{ m}\Omega$			

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 30 V ロジックレベル



$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	TO リードレス
<1					IPT004N03L $R_{DS(on)}=0.4\text{ m}\Omega$
1~2				IRFH8303TRPBF $R_{DS(on)}=1.1\text{ m}\Omega$	
				BSC011N03LS $R_{DS(on)}=1.1\text{ m}\Omega$	
				BSC011N03LSI** $R_{DS(on)}=1.1\text{ m}\Omega$	
				BSC011N03LST $R_{DS(on)}=1.1\text{ m}\Omega$	
				IRFH8307TRPBF $R_{DS(on)}=1.3\text{ m}\Omega$	
		IRF8301MTRPBF $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$		BSC0500NSI** $R_{DS(on)}=1.3\text{ m}\Omega$	
			BSZ0500NSI** $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$	BSC014N03LS G $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$	
		IRF8302MTRPBF** $R_{DS(on)}=1.8\text{ m}\Omega$	BSZ019N03LS $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$	BSC0901NS $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$	
			BSZ0901NS $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	BSC0501NSI** $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$	
	IPC055N03L3*** $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$	BSZ0501NSI** $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	BSC0901NSI** $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$		

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

www.infineon.com/baredie

** モノリシック集積類似ショットキーダイオード

*** $R_{DS(on)}$ 標準 @ $V_{GS}=4.5V$

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 30 V ロジックレベル



$R_{DS(on)}$, 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8	SO-8 デュアル	PQFN 2 x 2
2~4		IRF8304MTRPBF $R_{DS(on)}=2.2\text{ m}\Omega$	BSZ0901NSI** $R_{DS(on)}=2.1\text{ m}\Omega$	BSC020N03LS G $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$			
	IPC042N03L3**** $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$		IRLHM620TRPBF $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$	BSC0502NSI** $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$			
		IRF8306MTRPBF** $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$	BSZ0902NS $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$	BSC025N03LS G $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$			
				BSC0902NS $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$			
				IRF8252TRPBF $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$			
			BSZ0902NSI** $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$	BSC0902NSI** $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$	IRF8788TRPBF $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$		
			BSZ0502NSI** $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$	IRFH8316TRPBF $R_{DS(on)}=2.95\text{ m}\Omega$			
				BSC030N03LS G $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$			
			BSZ0503NSI** $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$	IRFH8318TRPBF $R_{DS(on)}=3.1\text{ m}\Omega$			
			IRLHM630*** $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$	BSC0503NSI** $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$	IRF7862TRPBF $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$		
			BSZ035N03LS G $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$	BSC034N03LS G $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$	IRF8734TRPBF $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$		
			IRFHM830 $R_{DS(on)}=3.8\text{ m}\Omega$	BSC0504NSI** $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$			
			BSZ0904NSI** $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$	BSC0904NSI** $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$			
4~10			IRFHM830D $R_{DS(on)}=4.3\text{ m}\Omega$	IRFH8324TRPBF $R_{DS(on)}=4.1\text{ m}\Omega$			
			BSZ0506NS $R_{DS(on)}=4.4\text{ m}\Omega$	BSC042N03LS G $R_{DS(on)}=4.2\text{ m}\Omega$			
			IRFHM8326TRPBF $R_{DS(on)}=4.7\text{ m}\Omega$	BSC0906NS $R_{DS(on)}=4.5\text{ m}\Omega$			
				IRFH8321TRPBF $R_{DS(on)}=4.9\text{ m}\Omega$			
	IPC028N03L3 $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$		BSZ050N03LS G $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$	IRFH8325TRPBF $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$	IRF8736TRPBF $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$		
			BSZ058N03LS G $R_{DS(on)}=5.8\text{ m}\Omega$	BSC050N03LS G $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$			
	IPC022N03L3 $R_{DS(on)}=5.3\text{ m}\Omega$		IRFHM8329TRPBF $R_{DS(on)}=6.1\text{ m}\Omega$	BSC052N03LS $R_{DS(on)}=5.2\text{ m}\Omega$			
			BSZ065N03LS $R_{DS(on)}=6.5\text{ m}\Omega$	BSC057N03LS G $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$			
		IRF8327S2 $R_{DS(on)}=7.3\text{ m}\Omega$	IRFHM8330TRPBF $R_{DS(on)}=6.6\text{ m}\Omega$	IRFH8330TRPBF $R_{DS(on)}=6.6\text{ m}\Omega$			
			BSZ0994NS $R_{DS(on)}=7.0\text{ m}\Omega$	BSC080N03LS G $R_{DS(on)}=8.0\text{ m}\Omega$			
			IRFHM831 $R_{DS(on)}=7.8\text{ m}\Omega$	IRFH8334TRPBF $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$	IRF8721TRPBF $R_{DS(on)}=8.5\text{ m}\Omega$		
			BSZ088N03LS G $R_{DS(on)}=8.8\text{ m}\Omega$	BSC090N03LS G $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$	IRF8714TRPBF $R_{DS(on)}=8.7\text{ m}\Omega$		
			IRFHM8334TRPBF $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$	BSC0909NS $R_{DS(on)}=9.2\text{ m}\Omega$			
		BSZ100N03LS G $R_{DS(on)}=10.0\text{ m}\Omega$					
10~63	IPC014N03L3 $R_{DS(on)}=10.3\text{ m}\Omega$		BSZ0909NS $R_{DS(on)}=12.0\text{ m}\Omega$	BSC120N03LS G $R_{DS(on)}=12.0\text{ m}\Omega$	IRF8707TRPBF $R_{DS(on)}=11.9\text{ m}\Omega$	IRF7907TRPBF $R_{DS(on)}=11.8\text{ m}\Omega+16.4\text{ m}\Omega$	IRLHS6342*** $R_{DS(on)}=16\text{ m}\Omega$
			IRFHM8337TRPBF $R_{DS(on)}=12.4\text{ m}\Omega$	IRFH8337TRPBF $R_{DS(on)}=12.8\text{ m}\Omega$	IRL6342 ¹⁾ *** $R_{DS(on)}=14.6\text{ m}\Omega$	IRF8513TRPBF $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega+15.5\text{ m}\Omega$	IRFHS8342 $R_{DS(on)}=16\text{ m}\Omega$
			BSZ130N03LS G $R_{DS(on)}=13.0\text{ m}\Omega$		IRL6372 ¹⁾ *** $R_{DS(on)}=18\text{ m}\Omega$; デュアル	IRF8313TRPBF $R_{DS(on)}=15.5\text{ m}\Omega+15.5\text{ m}\Omega$	IRLHS6376*** $R_{DS(on)}=63\text{ m}\Omega$; デュアル
			IRFHM8363TRPBF $R_{DS(on)}=14.9\text{ m}\Omega$			IRF7905TRPBF $R_{DS(on)}=17.1\text{ m}\Omega+21.8\text{ m}\Omega$	
2 x 7.2			BSC072N03LD G $R_{DS(on)}=7.2\text{ m}\Omega$				
2 x 15			BSC150N03LD G $R_{DS(on)}=15.0\text{ m}\Omega$				

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

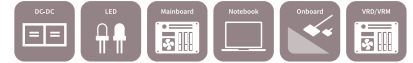
1) 2.5 V_{GS} 可能

** モノリシック集積類似ショットキーダイオード

*** $R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=4.5V$

**** $R_{DS(on)}$ 標準 @ $V_{GS}=4.5V$

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 30 V ロジックレベル 5 V optimized



$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8	SO-8 デュアル	SOT-23	TSOP-6
1~2		BSC014N03MS G $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$ BSC016N03MS G $R_{DS(on)}=1.6\text{ m}\Omega$ BSC020N03MS G $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$				
2~4	BSZ035N03MS G $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$	BSC025N03MS G $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$ BSC030N03MS G $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$	BSO033N03MS G $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$ BSO040N03MS G $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$			
4~10	BSZ050N03MS G $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$ BSZ058N03MS G $R_{DS(on)}=5.8\text{ m}\Omega$ BSZ088N03MS G $R_{DS(on)}=8.8\text{ m}\Omega$ BSZ100N03MS G $R_{DS(on)}=10.0\text{ m}\Omega$ BSZ130N03MS G $R_{DS(on)}=13.0\text{ m}\Omega$	BSC042N03MS G $R_{DS(on)}=4.2\text{ m}\Omega$ BSC050N03MS G $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$ BSC057N03MS G $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$ BSC080N03MS G $R_{DS(on)}=8.0\text{ m}\Omega$ BSC090N03MS G $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$ BSC100N03MS G $R_{DS(on)}=10.0\text{ m}\Omega$ BSC120N03MS G $R_{DS(on)}=12.0\text{ m}\Omega$				
>10			BSO110N03MS G $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$		IRLML0030 $R_{DS(on)}=27\text{ m}\Omega$ IRLML6344 ¹⁾ *** $R_{DS(on)}=29\text{ m}\Omega$ IRLML6346 ¹⁾ *** $R_{DS(on)}=63\text{ m}\Omega$ IRLML2030 $R_{DS(on)}=100\text{ m}\Omega$	IRLTS6342*** $R_{DS(on)}=14.6\text{ m}\Omega$ IRF7S8342 $R_{DS(on)}=19\text{ m}\Omega$
2 x 15				BSO150N03MD G $R_{DS(on)}=15.0\text{ m}\Omega$ BSO220N03MD G $R_{DS(on)}=22.0\text{ m}\Omega$		
2 x 22						



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 40 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7 ピン)	TO-220	TO-247	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	TO-220 FullPAK
<1			IRFS7430TRL7PP $R_{DS(on)}=0.75\text{ m}\Omega$			IPC218N04N3 $R_{DS(on)}=0.9\text{ m}\Omega$				
1~2		IRFS7430TRLPBF $R_{DS(on)}=1.3\text{ m}\Omega$ IPB015N04N G $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$ IRFS3004 $R_{DS(on)}=1.75\text{ m}\Omega$ IRFS7434TRLPBF $R_{DS(on)}=1.6\text{ m}\Omega$ IRFS7437TRLPBF $R_{DS(on)}=1.8\text{ m}\Omega$	IRFS7434TRL7PP $R_{DS(on)}=1.0\text{ m}\Omega$ IPB011N04N G $R_{DS(on)}=1.1\text{ m}\Omega$ IRFS3004-7P $R_{DS(on)}=1.25\text{ m}\Omega$ IRFS7437TRL7PP $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$ IPB020N04N G $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IRFB7430PBF $R_{DS(on)}=1.3\text{ m}\Omega$ IPPO15N04N G $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$ IRFB7434PBF $R_{DS(on)}=1.6\text{ m}\Omega$ IRFB7437PBF $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IRFP7430PBF $R_{DS(on)}=1.3\text{ m}\Omega$ IPPO15N04N G $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$ IRFB7434PBF $R_{DS(on)}=1.6\text{ m}\Omega$ IRFB7437PBF $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IPC171N04N $R_{DS(on)}=1.1\text{ m}\Omega$ IRF7739L1TRPBF $R_{DS(on)}=1.0\text{ m}\Omega$ IRF7480MTRPBF $R_{DS(on)}=1.2\text{ m}\Omega$ IRF7946TRPBF $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$ BSB015N04NX3 G $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$ IRF40DM229 $R_{DS(on)}=1.85\text{ m}\Omega$ IRF7483MTRPBF $R_{DS(on)}=2.3\text{ m}\Omega$	IRFH7084TRPBF $R_{DS(on)}=1.25\text{ m}\Omega$ IRFH7004TRPBF $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$ BSC017N04NS G $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$ IRF40H210 $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$ BSC019N04NS G $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$ IRFH7440TRPBF $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$ BSC030N04NS G $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$ IRFH7446TRPBF $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$ BSC054N04NS G $R_{DS(on)}=5.4\text{ m}\Omega$			
2~4	IRFR7440TRPBF $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$ IRFR7446TRPBF $R_{DS(on)}=3.9\text{ m}\Omega$	IRFS7440TRLPBF $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$ IRF1404S $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$		IPPO23N04N G $R_{DS(on)}=2.3\text{ m}\Omega$ IRFB7440PBF $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$ IRFB7446PBF $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$						
4~10	IRF40R207 $R_{DS(on)}=5.1\text{ m}\Omega$			IPPO41N04N G $R_{DS(on)}=4.1\text{ m}\Omega$ IRF40B207 $R_{DS(on)}=4.5\text{ m}\Omega$ IPPO48N04N G $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$						IPAO41N04N G $R_{DS(on)}=4.1\text{ m}\Omega$
>10								BSZ105N04NS G $R_{DS(on)}=10.5\text{ m}\Omega$ BSZ165N04NS G $R_{DS(on)}=16.5\text{ m}\Omega$		

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

1) 2.5 V_{GS} 可能

*** $R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=4.5V$



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 40 V ロジックレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7 ピン)	TO-220	TO-247	DirectFET™	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	TO リードレス
<1			IRL40SC228 $R_{DS(on)}=0.65\text{ m}\Omega$			IRL7472L1TRPBF $R_{DS(on)}=0.45\text{ m}\Omega$		BSC007N04LS6 $R_{DS(on)}=0.7\text{ m}\Omega$	IRL40T209 $R_{DS(on)}=0.8\text{ m}\Omega$
			IRL40SC209 $R_{DS(on)}=0.8\text{ m}\Omega$						
1~2		IPB015N04L G $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$	IPB011N04L G $R_{DS(on)}=1.1\text{ m}\Omega$	IRL40B209 $R_{DS(on)}=1.25\text{ m}\Omega$	IRLP3034PBF $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$	BSB014N04LX3 G $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$		BSC010N04LS $R_{DS(on)}=1.0\text{ m}\Omega$	
		IRLS3034TRLPBF $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$	IRLS3034TRL7P $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$	IRLB3034PBF $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$		IRL7486MTRPBF $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$		BSC010N04LS6 $R_{DS(on)}=1.0\text{ m}\Omega$	
		IRL40S212 $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$		IRL40B212 $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$				BSC010N04LST $R_{DS(on)}=1.0\text{ m}\Omega$	
								BSC010N04LSI $R_{DS(on)}=1.05\text{ m}\Omega$	
								BSC010N04LSC * $R_{DS(on)}=1.05\text{ m}\Omega$	
								BSC014N04LST $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$	
								BSC014N04LS $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$	
								BSC014N04LSI $R_{DS(on)}=1.45\text{ m}\Omega$	
								BSC016N04LS G $R_{DS(on)}=1.6\text{ m}\Omega$	
								BSZ018N04LS6 $R_{DS(on)}=1.8\text{ m}\Omega$	BSC018N04LS G $R_{DS(on)}=1.8\text{ m}\Omega$
2~4				IRL40B215 $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$			BSZ021N04LS6 $R_{DS(on)}=2.1\text{ m}\Omega$	BSC022N04LS $R_{DS(on)}=2.2\text{ m}\Omega$	
							BSZ024N04LS6 $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$	BSC022N04LS6 $R_{DS(on)}=2.2\text{ m}\Omega$	
				IPP039N04L G $R_{DS(on)}=3.9\text{ m}\Omega$			BSZ025N04LS $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$	BSC026N04LS $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$	
							BSZ028N04LS $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$	BSC027N04LS G $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$	
								BSC032N04LS $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$	
4~10		IPD036N04L G $R_{DS(on)}=3.6\text{ m}\Omega$	IRL1404S $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$				BSZ034N04LS $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$	BSC035N04LS G $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$	
		IRLR31142TRPBF $R_{DS(on)}=4.5\text{ m}\Omega$					BSZ040N04LS G $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$	BSC050N04LS G $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$	
							BSZ063N04LS6 $R_{DS(on)}=6.3\text{ m}\Omega$	BSC059N04LS G $R_{DS(on)}=5.9\text{ m}\Omega$	
								BSC059N04LS6 $R_{DS(on)}=5.9\text{ m}\Omega$	
							BSZ097N04LS G $R_{DS(on)}=9.7\text{ m}\Omega$	BSC093N04LS G $R_{DS(on)}=9.3\text{ m}\Omega$	

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

3) 近日発売

* 沿面距離を拡張



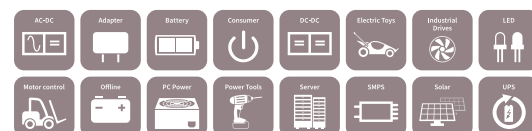
OptiMOS™ および StrongIRFET™ 60 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7 ピン)	TO-262 (IPAK)	TO-220	TO-220 FullPAK	TO-247
1~2			IPB010N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=1.0\text{ m}\Omega$				
			IRFS7530TRL7PP $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$				
			IPB014N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$				
			IPB017N06N3 G $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$				
2~4		IRFS7530TRLPBF $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IRFS7534TRL7PP $R_{DS(on)}=1.95\text{ m}\Omega$	IPI020N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IRFB7530PBF $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$		IRFP7530PBF $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$
	IPD025N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$	IRFS7534TRLPBF $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$	IRFS3006TRL7PP $R_{DS(on)}=2.1\text{ m}\Omega$		IPP020N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$		
		IRFS3006 $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$		IPI024N06N3 G $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$	IRFB7534PBF $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$		
		IPB026N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$			IPP024N06N3 G ²⁾ $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$		IRFP3006PBF $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$
		IPB029N06N3 G $R_{DS(on)}=2.9\text{ m}\Omega$		IPI029N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=2.9\text{ m}\Omega$	IPP029N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=2.9\text{ m}\Omega$	IPA029N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=2.9\text{ m}\Omega$	IRFP3206PBF $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$
	IPD033N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$	IRFS3206 $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$		IPI032N06N3 G $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$	IPP032N06N3 G $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$	IPA032N06N3 G $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$	
	IPD034N06N3 G $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$	IRFS7537TRLPBF $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$			IRFB7537PBF $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$		IRFP7537PBF $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$
	IPD038N06N3 G $R_{DS(on)}=3.8\text{ m}\Omega$	IPB037N06N3 G $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$			IPP040N06N3 G $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$		
		IRFS3306 $R_{DS(on)}=4.2\text{ m}\Omega$		IPI040N06N3 G $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$	IPP040N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$	IPA040N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$	
	4~10	IRFR7540TRPBF $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$	IRFS7540TRLPBF $R_{DS(on)}=5.1\text{ m}\Omega$			IRFB7540PBF $R_{DS(on)}=5.1\text{ m}\Omega$	IPA057N06N3 G $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$
IPD053N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=5.3\text{ m}\Omega$		IPB054N06N3 G $R_{DS(on)}=5.4\text{ m}\Omega$			IPP057N06N3 G ²⁾ $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$		
		IPB057N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$			IRFB7545PBF $R_{DS(on)}=5.9\text{ m}\Omega$		
IRFR7546TRPBF $R_{DS(on)}=7.9\text{ m}\Omega$		IRF1018ES $R_{DS(on)}=8.4\text{ m}\Omega$			IPP060N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=6.0\text{ m}\Omega$	IPA060N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=6.0\text{ m}\Omega$	
IPD088N06N3 G $R_{DS(on)}=8.8\text{ m}\Omega$					IRF60B217 $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$	IPA093N06N3 G $R_{DS(on)}=9.3\text{ m}\Omega$	
IRF60R217 $R_{DS(on)}=9.9\text{ m}\Omega$		IPB090N06N3 G $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$			IPP093N06N3 G $R_{DS(on)}=9.3\text{ m}\Omega$		
>10		IRFS3806 $R_{DS(on)}=15.8\text{ m}\Omega$					



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 60 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	TO リードレス
<1					IPT007N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=0.7\text{ m}\Omega$
1~2	IPC218N06N3 $R_{DS(on)}=1.3\text{ m}\Omega$	IRF7749L1TRPBF $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$		BSC012N06NS $R_{DS(on)}=1.2\text{ m}\Omega$	IPT012N06N ²⁾ $R_{DS(on)}=1.2\text{ m}\Omega$
				BSC014N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$	
				BSC014N06NST ²⁾ $R_{DS(on)}=1.45\text{ m}\Omega$	
				BSC016N06NST ²⁾ $R_{DS(on)}=1.6\text{ m}\Omega$	
2~4		IRF7748L1TRPBF $R_{DS(on)}=2.2\text{ m}\Omega$		BSC016N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=1.6\text{ m}\Omega$	
		BSB028N06NN3 G $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$		BSC019N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$	
		IRF60DM206 $R_{DS(on)}=2.9\text{ m}\Omega$		BSC028N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$	
				BSC028N06NST ²⁾ $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$	
4~10		IRF7580TRPBF $R_{DS(on)}=3.6\text{ m}\Omega$		BSC031N06NS3 G $R_{DS(on)}=3.1\text{ m}\Omega$	
	IRF6648 $R_{DS(on)}=7.0\text{ m}\Omega$		BSZ042N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=4.2\text{ m}\Omega$	IRFH7085TRPBF $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$	
	IRF6674 $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$			BSC034N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$	
				BSC039N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=3.9\text{ m}\Omega$	
>10			BSZ068N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=6.8\text{ m}\Omega$	IRLH5036TRPBF $R_{DS(on)}=4.4\text{ m}\Omega$	
				IRFH7545TRPBF $R_{DS(on)}=5.2\text{ m}\Omega$	
			BSZ100N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=10.0\text{ m}\Omega$	BSC066N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=6.6\text{ m}\Omega$	
				BSC076N06NS3 G $R_{DS(on)}=7.6\text{ m}\Omega$	
			BSZ110N06NS3 G $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$	BSC097N06NS ²⁾ $R_{DS(on)}=9.7\text{ m}\Omega$	
				BSC097N06NST ²⁾ $R_{DS(on)}=9.7\text{ m}\Omega$	
				BSC110N06NS3 G $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$	



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 60 V ロジックレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7ピン)	TO-262 (I ² PAK)	TO-220	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	PQFN 2 x 2	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SOT-23
1~2		IPB019N06L3 G $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$	IPB016N06L3 G $R_{DS(on)}=1.6\text{ m}\Omega$			IPC218N06L3 $R_{DS(on)}=1.2\text{ m}\Omega$			BSC014N06LS5 $R_{DS(on)}=1.4\text{ m}\Omega$	
		IRL60S216 $R_{DS(on)}=1.95\text{ m}\Omega$		IRL60SL216 $R_{DS(on)}=1.95\text{ m}\Omega$	IRL60B216 $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$					
2~4		IRLS3036TRLPBF $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$			IRLB3036PBF $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$				BSC027N06LS5 $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$	
	IPD031N06L3 G $R_{DS(on)}=3.1\text{ m}\Omega$	IPB034N06L3 G $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$			IPP037N06L3 G $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$				BSC028N06LS3 G $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$	
4~10	IPD048N06L3 G $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$				IPP052N06L3 G $R_{DS(on)}=5.2\text{ m}\Omega$			BSZ040N06LS5 $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$	IRLH5036TRPBF $R_{DS(on)}=4.4\text{ m}\Omega$	
	IRLR3636TRPBF $R_{DS(on)}=6.8\text{ m}\Omega$							BSZ065N06LS5 $R_{DS(on)}=6.5\text{ m}\Omega$	BSC065N06LS5 $R_{DS(on)}=6.5\text{ m}\Omega$	
	IPD079N06L3 G $R_{DS(on)}=7.9\text{ m}\Omega$	IPB081N06L3 G $R_{DS(on)}=8.1\text{ m}\Omega$		IPI084N06L3 G $R_{DS(on)}=8.4\text{ m}\Omega$	IPP084N06L3 G $R_{DS(on)}=8.4\text{ m}\Omega$			BSZ067N06LS3 G $R_{DS(on)}=6.7\text{ m}\Omega$	BSC067N06LS3 G $R_{DS(on)}=6.7\text{ m}\Omega$	
								BSZ099N06LS5 $R_{DS(on)}=9.9\text{ m}\Omega$	BSC094N06LS5 $R_{DS(on)}=9.4\text{ m}\Omega$	
>10								BSZ100N06LS3 G $R_{DS(on)}=10.0\text{ m}\Omega$	BSC100N06LS3 G $R_{DS(on)}=10.0\text{ m}\Omega$	
	IPD350N06L G $R_{DS(on)}=35.0\text{ m}\Omega$						IRL60HS118 $R_{DS(on)}=17.0\text{ m}\Omega$			IRLML0060 $R_{DS(on)}=92\text{ m}\Omega$ IRLML2060 $R_{DS(on)}=480\text{ m}\Omega$

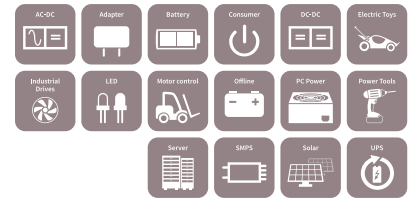
www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

2) 6 V 定格 ($R_{DS(on)}$ 指定 @ $V_{GS} = 6\text{ V}$)



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 75 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7ピン)	TO-220	TO-247	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	SuperSO8
1~2		IPB020NE7N3 G $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IRFS7730TRL7PP $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$		IRFP7718PBF $R_{DS(on)}=1.8\text{ m}\Omega$	IPC302NE7N3 $R_{DS(on)}=1.2\text{ m}\Omega$		
2~4		IRFS7730TRL7PP $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$		IPP023NE7N3 G $R_{DS(on)}=2.3\text{ m}\Omega$				
		IPB031NE7N3 G $R_{DS(on)}=3.1\text{ m}\Omega$	IRFS7734TRL7PP $R_{DS(on)}=3.05\text{ m}\Omega$	IRFB7730PBF $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$				BSC036NE7N3 G $R_{DS(on)}=3.6\text{ m}\Omega$
		IRFS7734TRL7PP $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$		IPP034NE7N3 G $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$				
4~10		IPB049NE7N3 G $R_{DS(on)}=4.9\text{ m}\Omega$		IPP052NE7N3 G $R_{DS(on)}=5.2\text{ m}\Omega$				BSC042NE7N3 G $R_{DS(on)}=4.2\text{ m}\Omega$
		IRFS7762TRL7PP $R_{DS(on)}=6.7\text{ m}\Omega$		IPP062NE7N3 G $R_{DS(on)}=6.2\text{ m}\Omega$			IRF7780MTRPBF $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$	
	IRFR7740TRPBF $R_{DS(on)}=7.2\text{ m}\Omega$			IRFB7740PBF $R_{DS(on)}=7.3\text{ m}\Omega$				
>10	IRFR7746TRPBF $R_{DS(on)}=11.2\text{ m}\Omega$	IRFS7787TRL7PP $R_{DS(on)}=8.4\text{ m}\Omega$		IRFB7787PBF $R_{DS(on)}=8.4\text{ m}\Omega$				IRFH7787TRPBF $R_{DS(on)}=8.0\text{ m}\Omega$
				IRFB7746PBF $R_{DS(on)}=10.6\text{ m}\Omega$			BSF450NE7NH3 ¹⁾ $R_{DS(on)}=45.0\text{ m}\Omega$	



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 80 V ノーマルレベル-ロジックレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7ピン)	TO-262 (I ² PAK)	TO-220	TO-220 FullPAK	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	PQFN 2 x 2	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	TO リードレス
1~2		IPB017N08N5 $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$	IPB015N08N5 $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$				IPC302N08N3 $R_{DS(on)}=1.2\text{ m}\Omega$					IPT012N08N5 $R_{DS(on)}=1.2\text{ m}\Omega$
		IPB020N08N5 $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IPB019N08N3 G $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$		IPP020N08N5 $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$						BSC021N08NS5 $R_{DS(on)}=2.1\text{ m}\Omega$	IPT019N08N5 $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$
2~4		IPB024N08N5 $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$			IPP023N08N5 $R_{DS(on)}=2.3\text{ m}\Omega$						BSC025N08LS5 $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$	
		IPB025N08N3 G $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$	IPB030N08N3 G $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$		IPP027N08N5 $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$						BSC026N08NS5 $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$	
					IPP028N08N3 G $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$	IPA028N08N3 G $R_{DS(on)}=2.8\text{ m}\Omega$					BSC030N08NS5 $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$	IPT029N08N5 $R_{DS(on)}=2.9\text{ m}\Omega$
		IPB031N08N5 $R_{DS(on)}=3.1\text{ m}\Omega$			IPP034N08N5 $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$						BSC037N08NS5 $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$	
											BSC037N08NS5T $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$	
4~10		IPB035N08N3 G $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$		IPI037N08N3 G $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$	IPP037N08N3 G $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$	IPA037N08N3 G $R_{DS(on)}=3.7\text{ m}\Omega$					BSC040N08NS5 $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$	
	IPD046N08N5 $R_{DS(on)}=4.6\text{ m}\Omega$	IPB049N08N5 $R_{DS(on)}=4.9\text{ m}\Omega$			IPP052N08N5 $R_{DS(on)}=5.2\text{ m}\Omega$			BSB044N08NN3 G $R_{DS(on)}=4.4\text{ m}\Omega$			BSC047N08NS3 G $R_{DS(on)}=4.7\text{ m}\Omega$	
	IPD053N08N3 G $R_{DS(on)}=5.3\text{ m}\Omega$	IPB054N08N3 G $R_{DS(on)}=5.4\text{ m}\Omega$			IPP057N08N3 G $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$	IPA057N08N3 G $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$					BSC052N08NS5 $R_{DS(on)}=5.2\text{ m}\Omega$	
		IPB067N08N3 G $R_{DS(on)}=6.7\text{ m}\Omega$									BSC057N08NS3 G $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$	
>10	IPD096N08N3 G $R_{DS(on)}=9.6\text{ m}\Omega$				IPP100N08N3 G $R_{DS(on)}=9.7\text{ m}\Omega$						BSZ070N08LS5 $R_{DS(on)}=7.0\text{ m}\Omega$	BSC057N08NS3 G $R_{DS(on)}=5.7\text{ m}\Omega$
								BSB104N08NP3 $R_{DS(on)}=10.4\text{ m}\Omega$	IRL80HS120 $R_{DS(on)}=32.0\text{ m}\Omega$	BSZ110N08NS5 $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$	BSC117N08NS5 $R_{DS(on)}=11.7\text{ m}\Omega$	
	IPD135N08N3 G $R_{DS(on)}=13.5\text{ m}\Omega$									BSZ123N08NS3 G $R_{DS(on)}=12.3\text{ m}\Omega$	BSC123N08NS3 $R_{DS(on)}=12.3\text{ m}\Omega$	
										BSZ340N08NS3 G $R_{DS(on)}=34.0\text{ m}\Omega$	BSC340N08NS3 G $R_{DS(on)}=34.0\text{ m}\Omega$	

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

1) DirectFET™ S

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 100 V ノーマルレベル



$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7ピン)	TO-262 (I ² PAK)	TO-220	TO-220 FullPAK	TO-247
1~2		IPB020N10N5 $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IPB017N10N5 $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$				IRF100P218 $R_{DS(on)}=1.1\text{ m}\Omega$
		IPB020N10N5LF $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$	IPB017N10N5LF $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$				IRF100P219 $R_{DS(on)}=2.1\text{ m}\Omega$
2~4		IPB027N10N3 G $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$	IPB024N10N5 $R_{DS(on)}=2.4\text{ m}\Omega$		IPP023N10N5 $R_{DS(on)}=2.3\text{ m}\Omega$		IRFP4468PBF $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$
		IPB027N10N5 $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$	IPB025N10N3 G $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$	IPI030N10N3 G $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$	IPP030N10N3 G $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$	IPA030N10N3 G $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$	
		IPB033N10N5LF $R_{DS(on)}=3.3\text{ m}\Omega$	IPB032N10N5 $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$		IPP030N10N5 $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$		
			IPB039N10N3 G $R_{DS(on)}=3.9\text{ m}\Omega$		IPP039N10N5 $R_{DS(on)}=3.9\text{ m}\Omega$		
4~10	IPD050N10N5 $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$	IPB042N10N3 G $R_{DS(on)}=4.2\text{ m}\Omega$		IPI045N10N3 G $R_{DS(on)}=4.5\text{ m}\Omega$	IRFB4110PBF $R_{DS(on)}=4.5\text{ m}\Omega$	IPA045N10N3 G $R_{DS(on)}=4.5\text{ m}\Omega$	IRFP4110PBF $R_{DS(on)}=4.5\text{ m}\Omega$
	IPD068N10N3 G $R_{DS(on)}=6.8\text{ m}\Omega$	IRFS4010TRL PBF $R_{DS(on)}=4.7\text{ m}\Omega$			IPP045N10N3 G $R_{DS(on)}=4.5\text{ m}\Omega$	IPA083N10N5 $R_{DS(on)}=8.3\text{ m}\Omega$	IRFP4310ZPBF $R_{DS(on)}=6.0\text{ m}\Omega$
		IPB065N10N3 G $R_{DS(on)}=6.5\text{ m}\Omega$			IRFB4310ZPBF $R_{DS(on)}=6.0\text{ m}\Omega$	IPA086N10N3 G $R_{DS(on)}=8.6\text{ m}\Omega$	
		IRFS4310ZTRL PBF $R_{DS(on)}=7.0\text{ m}\Omega$					
				IPI072N10N3 G $R_{DS(on)}=7.2\text{ m}\Omega$	IPP072N10N3 G $R_{DS(on)}=7.2\text{ m}\Omega$		
	IPD082N10N3 G $R_{DS(on)}=8.2\text{ m}\Omega$				IPP083N10N5 $R_{DS(on)}=8.3\text{ m}\Omega$		
		IPB083N10N3 G $R_{DS(on)}=8.3\text{ m}\Omega$		IPI086N10N3 G $R_{DS(on)}=8.6\text{ m}\Omega$	IPP086N10N3 G $R_{DS(on)}=8.6\text{ m}\Omega$		
	IRFS4410ZTRL PBF $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$			IRFS4410ZTRL PBF $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$		IRFP4410ZPBF $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$	
10~25	IPD122N10N3 G $R_{DS(on)}=12.2\text{ m}\Omega$						
	IPD12CN10N G $R_{DS(on)}=12.4\text{ m}\Omega$	IPB123N10N3 G $R_{DS(on)}=12.3\text{ m}\Omega$					
	IRFR4510TRPBF $R_{DS(on)}=13.9\text{ m}\Omega$	IRFS4510TRL PBF $R_{DS(on)}=13.9\text{ m}\Omega$					
	IPD180N10N3 G $R_{DS(on)}=18.0\text{ m}\Omega$			IPI180N10N3 G $R_{DS(on)}=18.0\text{ m}\Omega$			
	IPD25CN10N G $R_{DS(on)}=25.0\text{ m}\Omega$						
>25	IPD33CN10N G $R_{DS(on)}=33.0\text{ m}\Omega$						
	IPD78CN10N G $R_{DS(on)}=78.0\text{ m}\Omega$						



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 100 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8	TO リードレス
1~2	IPC302N10N3 $R_{DS(on)}=1.7\text{ m}\Omega$					IPT015N10N5 $R_{DS(on)}=1.5\text{ m}\Omega$
	IPC313N10N3R $R_{DS(on)}=1.9\text{ m}\Omega$			BSC027N10NS5 $R_{DS(on)}=2.7\text{ m}\Omega$		IPT020N10N3 $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$ IPT020N10N5 $R_{DS(on)}=2.0\text{ m}\Omega$
2~4	IPC26N10NR $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$	IRF7769L1TRPBF $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$		BSC035N10NS5 $R_{DS(on)}=3.5\text{ m}\Omega$		IPT026N10N5 $R_{DS(on)}=2.6\text{ m}\Omega$
	IPC173N10N3 $R_{DS(on)}=3.6\text{ m}\Omega$			BSC040N10NS5 $R_{DS(on)}=4.0\text{ m}\Omega$		
4~10		IRF100DM116 ³⁾ $R_{DS(on)}=4.3\text{ m}\Omega$		BSC050N10N5 $R_{DS(on)}=5.0\text{ m}\Omega$		
		BSB056N10NN3 G $R_{DS(on)}=5.6\text{ m}\Omega$		BSC060N10NS3 G $R_{DS(on)}=6.0\text{ m}\Omega$		
				BSC070N10NS3 G $R_{DS(on)}=7.0\text{ m}\Omega$		
				BSC070N10NS5 $R_{DS(on)}=7.0\text{ m}\Omega$		
				IRFH5010TRPBF $R_{DS(on)}=9.0\text{ m}\Omega$		
10~25			BSZ097N10NS5 $R_{DS(on)}=9.7\text{ m}\Omega$	BSC098N10NS5 $R_{DS(on)}=9.8\text{ m}\Omega$		
				BSC109N10NS3 G $R_{DS(on)}=10.9\text{ m}\Omega$		
				BSC118N10NS G $R_{DS(on)}=11.8\text{ m}\Omega$		
		BSF134N10NJ3 G ¹⁾ $R_{DS(on)}=13.4\text{ m}\Omega$		IRFH7110TRPBF $R_{DS(on)}=13.5\text{ m}\Omega$		
	IPC045N10N3 $R_{DS(on)}=15.2\text{ m}\Omega$		BSZ160N10NS3 G $R_{DS(on)}=16.0\text{ m}\Omega$	BSC160N10NS3 G $R_{DS(on)}=16.0\text{ m}\Omega$		
>25		IRF662TRPBF $R_{DS(on)}=22.0\text{ m}\Omega$		BSC196N10NS G $R_{DS(on)}=19.6\text{ m}\Omega$	IRF7853TRPBF $R_{DS(on)}=18.0\text{ m}\Omega$	
		IRF6645TRPBF $R_{DS(on)}=35.0\text{ m}\Omega$	BSZ440N10NS3 G $R_{DS(on)}=44.0\text{ m}\Omega$	BSC252N10NSF G $R_{DS(on)}=25.2\text{ m}\Omega$		
		IRF7665S2TRPBF $R_{DS(on)}=62.0\text{ m}\Omega$		BSC440N10NS3 G $R_{DS(on)}=44.0\text{ m}\Omega$		
2 x 75				BSC750N10ND G $R_{DS(on)}=75.0\text{ m}\Omega$; デュアル		
2 x 195			IRFHM792TRPBF $R_{DS(on)}=195.0\text{ m}\Omega$			

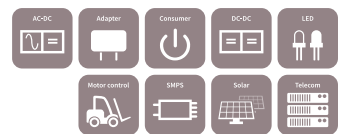
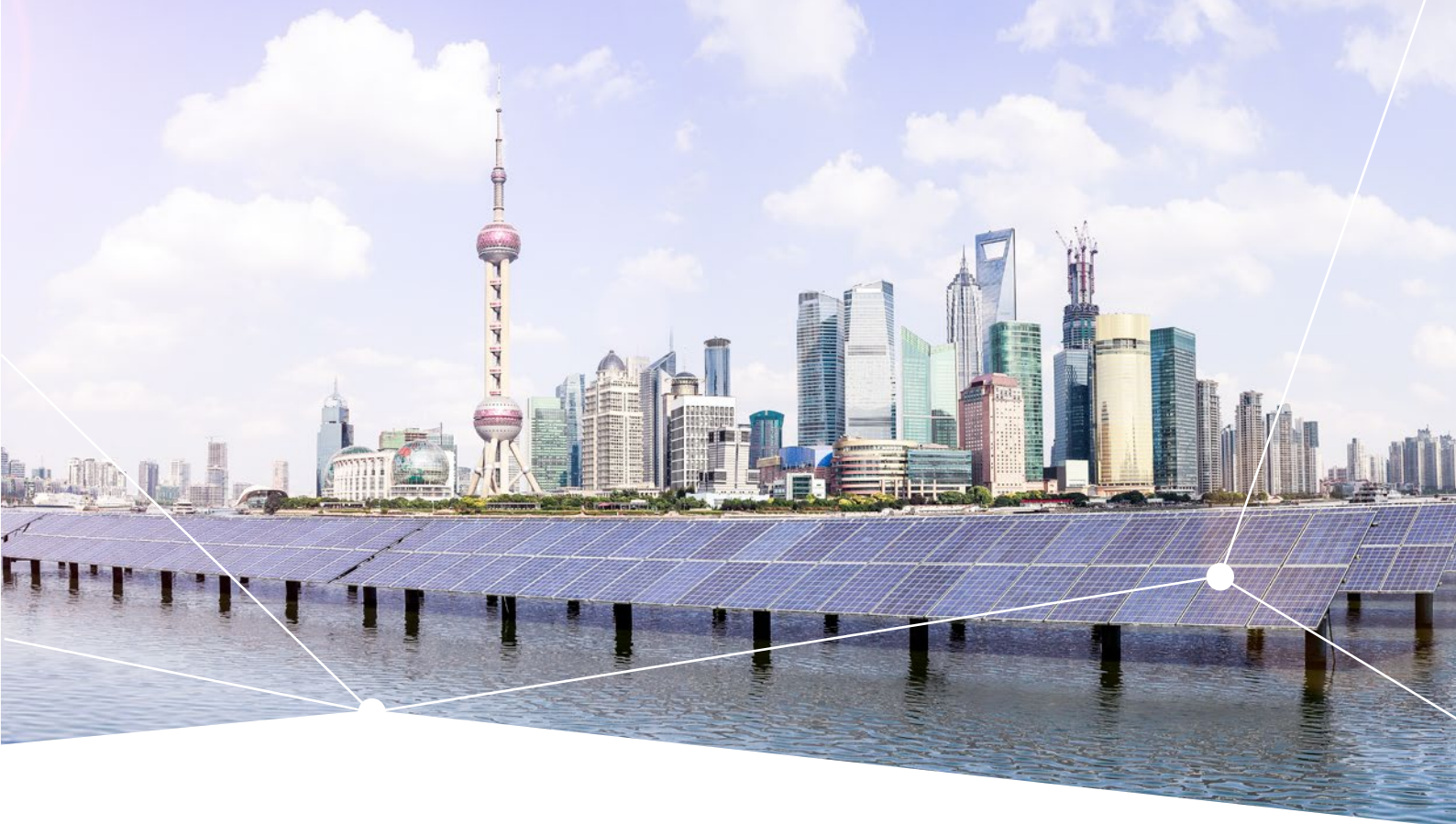
OptiMOS™ および StrongIRFET™ 100 V ロジックレベル



$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10V$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7ピン)	TO-220	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	PQFN 2 x 2	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SOT-23
2~4			IRLS4030TRL7PP $R_{DS(on)}=3.9\text{ m}\Omega$					BSC034N10LS5 $R_{DS(on)}=3.4\text{ m}\Omega$	
4~10		IRLS4030TRLPBF $R_{DS(on)}=4.3\text{ m}\Omega$		IRLB4030PBF $R_{DS(on)}=4.3\text{ m}\Omega$			BSZ096N10LS5 $R_{DS(on)}=9.6\text{ m}\Omega$		
10~25				IPP12CN10L G $R_{DS(on)}=12.0\text{ m}\Omega$	IPC045N10L3 ²⁾ $R_{DS(on)}=16.0\text{ m}\Omega$		BSZ146N10LS5 $R_{DS(on)}=14.6\text{ m}\Omega$	BSC123N10LS G $R_{DS(on)}=12.3\text{ m}\Omega$	
	IRLR3110ZTRPBF $R_{DS(on)}=14.0\text{ m}\Omega$						BSZ150N10LS3 $R_{DS(on)}=15.0\text{ m}\Omega$	BSC146N10LS5 $R_{DS(on)}=14.6\text{ m}\Omega$	
>25					IPC020N10L3 ²⁾ $R_{DS(on)}=42.0\text{ m}\Omega$	IRL100HS121 $R_{DS(on)}=42.0\text{ m}\Omega$		BSC265N10LSF G $R_{DS(on)}=26.5\text{ m}\Omega$	IRLML0100 $R_{DS(on)}=220\text{ m}\Omega$

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

- 1) DirectFET™ S
- 2) $R_{DS(on)}$ 標準 指定 @ 4.5 V
- 3) 近日発売



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 120 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7ピン)	TO-262 (I ² PAK)	TO-220	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8
2~4						IPC302N12N3 $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$		
		IPB038N12N3 G $R_{DS(on)}=3.8\text{ m}\Omega$	IPB036N12N3 G $R_{DS(on)}=3.6\text{ m}\Omega$			IPC26N12N $R_{DS(on)}=3.0\text{ m}\Omega$ IPC26N12NR $R_{DS(on)}=3.2\text{ m}\Omega$		
4~10				IPI041N12N3 G $R_{DS(on)}=4.1\text{ m}\Omega$	IPP041N12N3 G $R_{DS(on)}=4.1\text{ m}\Omega$			
					IPP048N12N3 G $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$			
10~25	IPD110N12N3 G $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$			IPI076N12N3 G $R_{DS(on)}=7.6\text{ m}\Omega$	IPP076N12N3 G $R_{DS(on)}=7.6\text{ m}\Omega$			BSC077N12NS3 G $R_{DS(on)}=7.7\text{ m}\Omega$
		IPB144N12N3 G $R_{DS(on)}=14.4\text{ m}\Omega$		IPI147N12N3 G $R_{DS(on)}=14.7\text{ m}\Omega$	IPP147N12N3 G $R_{DS(on)}=14.7\text{ m}\Omega$		BSZ240N12NS3 G $R_{DS(on)}=24.0\text{ m}\Omega$	BSC190N12NS3 G $R_{DS(on)}=19.0\text{ m}\Omega$



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 135-150 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$, 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	TO リードレス
4~10	IPC302N15N3 $R_{DS(on)}=4.9\text{ m}\Omega$ IPC300N15N3R $R_{DS(on)}=4.9\text{ m}\Omega$			BSC093N15NS5 $R_{DS(on)}=9.3\text{ m}\Omega$	IPT059N15N3 $R_{DS(on)}=5.9\text{ m}\Omega$
10~25		IRF779L2TRPBF ⁵⁾ $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$		BSC110N15NS5 $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$ BSC160N15NS5 $R_{DS(on)}=16.0\text{ m}\Omega$ BSC190N15NS3 G $R_{DS(on)}=19.0\text{ m}\Omega$	
>25		BSB165N15N3 G $R_{DS(on)}=16.5\text{ m}\Omega$ BSB280N15N3 G $R_{DS(on)}=28.0\text{ m}\Omega$ IRF6643TRPBF $R_{DS(on)}=34.5\text{ m}\Omega$ IRF6775MTRPBF $R_{DS(on)}=56.0\text{ m}\Omega$	BSZ300N15NS5 $R_{DS(on)}=30.0\text{ m}\Omega$ BSZ520N15NS3 G $R_{DS(on)}=52.0\text{ m}\Omega$ BSZ900N15NS3 G $R_{DS(on)}=90.0\text{ m}\Omega$	BSC360N15NS3 G $R_{DS(on)}=36.0\text{ m}\Omega$ BSC520N15NS3 G $R_{DS(on)}=52.0\text{ m}\Omega$	



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 135-150 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$, 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK 7ピン)	TO-263 (D ² PAK 7ピン+)	TO-251/ TO-251 ショート リード (IPAK/IPAK ショー トリード)	TO-262 (I-PAK)	TO-220	TO-220 FullPAK	TO-247
4~10		IPB048N15N5 $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$	IPB044N15N5 $R_{DS(on)}=4.4\text{ m}\Omega$			IPI051N15N5 $R_{DS(on)}=5.1\text{ m}\Omega$	IPP051N15N5 ²⁾ $R_{DS(on)}=5.1\text{ m}\Omega$		IRF150P220 $R_{DS(on)}=2.5\text{ m}\Omega$ IRF150P221 $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$ IRFP4568PBF $R_{DS(on)}=5.9\text{ m}\Omega$
		IPB048N15N5LF $R_{DS(on)}=4.8\text{ m}\Omega$	IRF135SA204 ⁵⁾ $R_{DS(on)}=5.9\text{ m}\Omega$	IRF135SA204 $R_{DS(on)}=5.9\text{ m}\Omega$					
		IPB072N15N3 G $R_{DS(on)}=7.2\text{ m}\Omega$	IPB060N15N5 $R_{DS(on)}=6.0\text{ m}\Omega$			IPI075N15N3 G $R_{DS(on)}=7.5\text{ m}\Omega$	IPP075N15N3 G $R_{DS(on)}=7.5\text{ m}\Omega$		
		IPB073N15N5 $R_{DS(on)}=7.3\text{ m}\Omega$	IPB065N15N3 G $R_{DS(on)}=6.5\text{ m}\Omega$			IPI076N15N5 $R_{DS(on)}=7.6\text{ m}\Omega$	IPP076N15N5 $R_{DS(on)}=7.6\text{ m}\Omega$	IPA075N15N3 G $R_{DS(on)}=7.5\text{ m}\Omega$	
		IPB083N15N5LF $R_{DS(on)}=8.3\text{ m}\Omega$							
		IRF135S203 ⁵⁾ $R_{DS(on)}=8.4\text{ m}\Omega$						IRF135B203 ⁵⁾ $R_{DS(on)}=8.4\text{ m}\Omega$	
10~25		IPB108N15N3 G $R_{DS(on)}=10.8\text{ m}\Omega$	IRFS4115TRL7PP $R_{DS(on)}=11.8\text{ m}\Omega$			IPI111N15N3 G $R_{DS(on)}=11.1\text{ m}\Omega$	IPP111N15N3 G $R_{DS(on)}=11.1\text{ m}\Omega$	IPA105N15N3 G $R_{DS(on)}=10.5\text{ m}\Omega$	
		IRFS4321 $R_{DS(on)}=15.0\text{ m}\Omega$	IRFS4321TRL7PP $R_{DS(on)}=14.7\text{ m}\Omega$				IRFB4321PBF $R_{DS(on)}=15.0\text{ m}\Omega$		IRFP4321PBF $R_{DS(on)}=15.5\text{ m}\Omega$
		IPD200N15N3 G $R_{DS(on)}=20.0\text{ m}\Omega$	IPB200N15N3 G $R_{DS(on)}=20.0\text{ m}\Omega$				IPP200N15N3 G ²⁾ $R_{DS(on)}=20.0\text{ m}\Omega$		
>25		IRFS4615PBF $R_{DS(on)}=42.0\text{ m}\Omega$					IRFB4615PBF $R_{DS(on)}=39.0\text{ m}\Omega$		
		IRFR4615 $R_{DS(on)}=42.0\text{ m}\Omega$	IRFS5615PBF $R_{DS(on)}=42.0\text{ m}\Omega$		IRFU4615PBF $R_{DS(on)}=42.0\text{ m}\Omega$		IRFB5615PBF $R_{DS(on)}=39.0\text{ m}\Omega$		
		IPD530N15N3 G $R_{DS(on)}=53.0\text{ m}\Omega$	IPB530N15N3 G $R_{DS(on)}=53.0\text{ m}\Omega$			IPI530N15N3 G ²⁾ $R_{DS(on)}=53.0\text{ m}\Omega$	IPP530N15N3 G ²⁾ $R_{DS(on)}=53.0\text{ m}\Omega$		
							IRFB4019PBF $R_{DS(on)}=95.0\text{ m}\Omega$		

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

2) 8 V 定格 ($R_{DS(on)}$ 指定 @ $V_{GS} = 8\text{ V}$)

3) 開発中

5) 135 V



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 200 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-263 (D ² PAK+)	TO-262 (I ² PAK)	TO-220	TO-247
4~10						IRF200P222 $R_{DS(on)}=6.6\text{ m}\Omega$ IRFP4668PBF $R_{DS(on)}=9.7\text{ m}\Omega$
10~25		IPB107N20N3 G $R_{DS(on)}=10.7\text{ m}\Omega$	IRF200S234 $R_{DS(on)}=16.9\text{ m}\Omega$	IPI110N20N3 G $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$	IPP110N20N3 G $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$	IRF200P223 $R_{DS(on)}=11.5\text{ m}\Omega$
		IPB107N20NA ⁴⁾ $R_{DS(on)}=10.7\text{ m}\Omega$				
		IPB110N20N3LF $R_{DS(on)}=11.0\text{ m}\Omega$			IPP120N20NFD $R_{DS(on)}=12.0\text{ m}\Omega$	IRFP4127PBF $R_{DS(on)}=21.0\text{ m}\Omega$
		IPB117N20NFD $R_{DS(on)}=11.7\text{ m}\Omega$			IRFB4127PBF $R_{DS(on)}=20.0\text{ m}\Omega$	IRFP4227PBF $R_{DS(on)}=25.0\text{ m}\Omega$
		IPB156N22NFD ²⁾ $R_{DS(on)}=15.6\text{ m}\Omega$				
>25		IRFS4127TRL PBF $R_{DS(on)}=22.0\text{ m}\Omega$				
		IRFS4227TRL PBF $R_{DS(on)}=26.0\text{ m}\Omega$			IRFB4227PBF $R_{DS(on)}=26.0\text{ m}\Omega$	
	IPD320N20N3 G $R_{DS(on)}=32.0\text{ m}\Omega$	IPB320N20N3 G $R_{DS(on)}=32.0\text{ m}\Omega$		IPI320N20N3 G $R_{DS(on)}=32.0\text{ m}\Omega$	IPP320N20N3 G $R_{DS(on)}=32.0\text{ m}\Omega$	
	IRFR4620TRL PBF $R_{DS(on)}=78.0\text{ m}\Omega$	IRFS4620TRL PBF $R_{DS(on)}=78.0\text{ m}\Omega$			IRFB4620PBF $R_{DS(on)}=72.5\text{ m}\Omega$	
		IRFS4020TRL PBF $R_{DS(on)}=105.0\text{ m}\Omega$			IRFB5620PBF $R_{DS(on)}=72.5\text{ m}\Omega$ IRFB4020PBF $R_{DS(on)}=100.0\text{ m}\Omega$ IRF200B211 $R_{DS(on)}=170.0\text{ m}\Omega$	

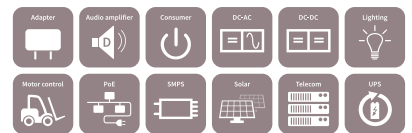


OptiMOS™ および StrongIRFET™ 200 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	DirectFET™	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8	TO リードレス	TO-247
4~10	IPC300N20N3 $R_{DS(on)}=9.2\text{ m}\Omega$ IPC302N20N3 $R_{DS(on)}=9.2\text{ m}\Omega$						IRF200P222 $R_{DS(on)}=6.6\text{ m}\Omega$
10~25	IPC302N20NFD $R_{DS(on)}=9.4\text{ m}\Omega$			BSC220N20NSFD $R_{DS(on)}=22.0\text{ m}\Omega$		IPT111N20NFD $R_{DS(on)}=11.1\text{ m}\Omega$	IRF200P223 $R_{DS(on)}=11.5\text{ m}\Omega$
>25				BSC320N20NS3 G $R_{DS(on)}=32.0\text{ m}\Omega$ BSC350N20NSFD $R_{DS(on)}=35.0\text{ m}\Omega$ BSC500N20NS3G $R_{DS(on)}=50.0\text{ m}\Omega$			
		IRF6641TRPBF $R_{DS(on)}=59.9\text{ m}\Omega$		IRFH5020 $R_{DS(on)}=55.0\text{ m}\Omega$			
			BSZ900N20NS3 G $R_{DS(on)}=90.0\text{ m}\Omega$	BSC900N20NS3 G $R_{DS(on)}=90.0\text{ m}\Omega$	IRF7820TRPBF $R_{DS(on)}=78.0\text{ m}\Omega$		
		IRF6785TRPBF $R_{DS(on)}=100.0\text{ m}\Omega$		BSZ12DN20NS3 G $R_{DS(on)}=125.0\text{ m}\Omega$ BSZ22DN20NS3 G $R_{DS(on)}=225.0\text{ m}\Omega$	BSC12DN20NS3 G $R_{DS(on)}=125.0\text{ m}\Omega$ BSC22DN20NS3 G $R_{DS(on)}=225.0\text{ m}\Omega$		

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

- 2) 220 V 定格
- 3) 開発中
- 4) AEC Q101 準拠部品



OptiMOS™ および StrongIRFET™ 250 V ノーマルレベル

$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-262 (I ² PAK)	TO-220	TO-247	Bare die ($R_{DS(on)}$ 標準)	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	TO リードレス
10~25		IPB200N25N3 G $R_{DS(on)}=20.0\text{ m}\Omega$	IPI200N25N3 G $R_{DS(on)}=20.0\text{ m}\Omega$	IPP200N25N3 G $R_{DS(on)}=20.0\text{ m}\Omega$	IRF250P224 $R_{DS(on)}=12.0\text{ m}\Omega$				
				IPP220N25NFD $R_{DS(on)}=22.0\text{ m}\Omega$	IRFP4768PBF $R_{DS(on)}=17.5\text{ m}\Omega$	IPC302N25N3 $R_{DS(on)}=16.0\text{ m}\Omega$			IPT210N25NFD $R_{DS(on)}=21.0\text{ m}\Omega$
					IRF250P225 $R_{DS(on)}=22.0\text{ m}\Omega$				
>25		IRFS4229TRL PBF $R_{DS(on)}=48.0\text{ m}\Omega$		IRFB4332PBF $R_{DS(on)}=33.0\text{ m}\Omega$	IRFP4332PBF $R_{DS(on)}=33.0\text{ m}\Omega$			BSC430N25NSFD $R_{DS(on)}=43.0\text{ m}\Omega$	
								BSC600N25NS3 G $R_{DS(on)}=60.0\text{ m}\Omega$	
								BSC670N25NSFD $R_{DS(on)}=67.0\text{ m}\Omega$	
		IPD600N25N3 G $R_{DS(on)}=60.0\text{ m}\Omega$	IPB600N25N3 G $R_{DS(on)}=60.0\text{ m}\Omega$	IPI600N25N3 G $R_{DS(on)}=60.0\text{ m}\Omega$	IRFB4229PBF $R_{DS(on)}=46.0\text{ m}\Omega$	IRFP4229PBF $R_{DS(on)}=46.0\text{ m}\Omega$		BSZ16DN25NS3 G $R_{DS(on)}=165.0\text{ m}\Omega$	IRFH5025 $R_{DS(on)}=100.0\text{ m}\Omega$
				IPP600N25N3 G $R_{DS(on)}=60.0\text{ m}\Omega$		IPC045N25N3 $R_{DS(on)}=146.0\text{ m}\Omega$	BSZ42DN25NS3 G $R_{DS(on)}=425.0\text{ m}\Omega$	BSC16DN25NS3 G $R_{DS(on)}=165.0\text{ m}\Omega$	

OptiMOS™ および StrongIRFET™ 300 V ノーマルレベル



$R_{DS(on)}$ 最大 @ $V_{GS}=10\text{ V}$ [mΩ]	TO-263 (D ² PAK)	TO-220	TO-247	SuperSO8
0~25			IRF300P226 $R_{DS(on)}=19.0\text{ m}\Omega$	
>25	IPB407N30N $R_{DS(on)}=40.7\text{ m}\Omega$	IPP410N30N $R_{DS(on)}=41.0\text{ m}\Omega$	IRFP4868PBF $R_{DS(on)}=32.0\text{ m}\Omega$	
			IRF300P227 $R_{DS(on)}=40.0\text{ m}\Omega$	
		IRFB4137PBF $R_{DS(on)}=69.0\text{ m}\Omega$	IRFP4137PBF $R_{DS(on)}=69.0\text{ m}\Omega$	BSC13DN30NSFD $R_{DS(on)}=130.0\text{ m}\Omega$

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

小信号 P チャンネル



電圧 [V]	SOT-223	TSOP-6	SOT-89	SC59	SOT-23	SOT-323	SOT-363
-250	BSP317P 4 Ω, -0.43 A, LL		BSS192P 12 Ω, -0.19 A, LL	BSR92P 11 Ω, -0.14 A, LL			
	BSP92P 12 Ω, -0.26 A, LL						
-100	BSP321P 900 mΩ, -0.98 A, NL						
	BSP322P 800 mΩ, -1.0 A, LL						
	BSP316P 1.8 Ω, -0.68 A, LL			BSR316P 1.8 Ω, -0.36 A, LL			
-60	BSP612P 120 mΩ, 3 A, LL				ISS17EP06LM 1.7 Ω, -0.3 A, LL		
	BSP613P 130 mΩ, 2.9 A, NL				BSS83P 2 Ω, -0.33 A, LL	BSS84PW 8 Ω, -0.15 A, LL	
	BSP170P 300 mΩ, -1.9 A, NL				ISS55EP06LM 5.5 Ω, -0.18 A, NL		
	BSP171P 300 mΩ, -1.9 A, LL				BSS84P 8 Ω, -0.17 A, LL		
	BSP315P 800 mΩ, -1.17 A, LL						
	ISP650P06NM 65 mΩ, -3.7 A, NL			BSR315P 800 mΩ, -0.62 A, LL			
	ISP12DP06NM 125 mΩ, -2.8, NL						
	ISP25DP06LM 250 mΩ, -1.9 A, LL						
	ISP25DP06NM 250 mΩ, -1.9 A, NL						
	ISP75DP06LM 750 mΩ, -1.1 A, LL						
-30		BSL303SPE 33 mΩ, -6.3 A, LL			BSS308PE 80 mΩ, -2.1 A, LL, ESD		BSD314SPE 140 mΩ, -1.5 A, LL, ESD
		IRFTS9342TRPBF* 40 mΩ, -5.8 Am, LL			BSS314PE 140 mΩ, -1.5 A, LL, ESD		
		BSL307SP 43 mΩ, -5.5 Am, LL			BSS315P 150 mΩ, -1.5 Am, LL		
		BSL305SPE 45 mΩ, -5.5 Am, LL					
		BSL308PE 80 mΩ, -2.1 A, LL, デュアル, ESD					
		BSL314PE 140 mΩ, -1.5 A, LL, ESD, デュアル					
-20		BSL207SP 41 mΩ, -6 A, SLL			IRLML2244* ¹⁾ 54 mΩ, 4.3 Am, LL		
		BSL211SP 67 mΩ, -4.7 A, SLL			IRLML2246* ¹⁾ 135 mΩ, 2.6 Am, LL	BSS209PW 550 mΩ, -0.58 A, SLL	BSV236SP 175 mΩ, -1.5 A, SLL
					BSS215P 150 mΩ, -1.5 A, SLL	BSS223PW 1.2 Ω, -0.39 A, SLL	BSD223P 1.2 Ω, -0.39 A, SLL, デュアル

小信号コンプリメンタリ



電圧 [V]	SOT-223	TSOP-6	SOT-89	SC59	SOT-23	SOT-323	SOT-363
-20/20		BSL215C N:140 mΩ, 1.5 A, SLL P:150 mΩ, 1.5 A, SLL					BSD235C N:350 mΩ, 0.95 A, SLL P:1.2 Ω, 0.53 A, SLL
-30/30		BSL308C N:57 mΩ, 2.3 Am, LL P:80 mΩ, -2.0 Am, LL					
		BSL316C N:160 mΩ, 1.4 Am, LL P:150 mΩ, -1.5 Am, LL					

www.infineon.com/smallsignal

全製品が自動車用 AEC Q101 に適合(*付きの部品を除く)

¹⁾ R_{DS(on)} 4.5 V 定格

小信号 N チャンネル



電圧 [V]	SOT-223	TSOP-6	SOT-89	SC59	SOT-23	SOT-323	SOT-363
20		BSL802SN 22 mΩ, 7.5 A, ULL		BSR802N 23 mΩ, 3.7 A, ULL	IRLML6244* ¹⁾ 21 mΩ, 6.3 Am, LL		
		BSL202SN 22 mΩ, 7.5 A, SLL		BSR202N 21 mΩ, 3.8 A, SLL	IRLML6246* ¹⁾ 46 mΩ, 4.1 Am, LL		
		BSL205N 50 mΩ, 2.5 A, SLL, デュアル			BSS205N 50 mΩ, 2.5 A, SLL		BSD214SN 140 mΩ, 1.5 A, SLL
					BSS806NE 57 mΩ, 2.3 A, ULL, ESD		BSD816SN 160 mΩ, 1.4 A, ULL
		BSL207N 70 mΩ, 2.1 A, SLL, デュアル			BSS806N 57 mΩ, 2.3 A, ULL	BSS214NW 140 mΩ, 1.5 A, SLL	BSD235N 350 mΩ, 0.95 A, SLL, デュアル
		BSL214N 140 mΩ, 1.5 A, SLL, デュアル			BSS214N 140 mΩ, 1.5 A, SLL	BSS816NW 160 mΩ, 1.4 A, ULL	BSD840N 400 mΩ, 0.88 A, ULL, デュアル
25					IRFML8244* 24 mΩ, 5.8 A, NL		
30		IRLTS6342* ¹⁾ 17.5 mΩ, 8.3 Am, LL		BSR302N 23 mΩ, 3.7 Am, LL	IRLML0030* 27 mΩ, 5.3 Am, LL		BSD316SN 160 mΩ, 1.4 Am, LL
		IRFTS8342* 19 mΩ, 8.2 A, NL			IRLML6344* ¹⁾ 29 mΩ, 5.0 Am, LL		
		BSL302SN 25 mΩ, 7.1 Am, LL			BSS306N 57 mΩ, 2.3 Am, LL		
		BSL306N 57 mΩ, 2.3 A, LL, デュアル			IRLML6346* ¹⁾ 63 mΩ, 3.4 Am, LL		
					IRLML2030* 100 mΩ, 1.4 Am, LL		
60					BSS316N 160 mΩ, 1.4 Am, LL		
					BSS670S2L 650 mΩ, 0.54 Am, LL	BSS340NW 400 mΩ, 0.88 Am, LL	
	BSP318S 90 mΩ, 2.6 Am, LL	BSL606SN 60 mΩ, 4.5 Am, LL	BSS606N 60 mΩ, 3.2 Am, LL	BSR606N 60 mΩ, 2.3 Am, LL	IRLML0060* 92 mΩ, 2.7 Am, LL	BSS138W 3.5 Ω, 0.28 A, LL	2N7002DW 3 Ω, 0.3 A, LL, デュアル
	BSP320S 120 mΩ, 2.9 A, NL				IRLML2060* 480 mΩ, 1.2 Am, LL	SN7002W 5 Ω, 0.23 A, LL	
	BSP295 300 mΩ, 1.8 A, LL				BSS138N 3.5 Ω, 0.23 A, LL		
					BSS7728N 5 Ω, 0.2 A, LL		
					SN7002N 5 Ω, 0.2 A, LL		
					2N7002 3 Ω, 0.3 A, LL		
75	BSP716N 160 mΩ, 2.3 Am, LL	BSL716SN 150 mΩ, 2.5 Am, LL			BSS159N 8 Ω, 0.13 A, デプレッション		
80							
100	BSP372N 230 mΩ, 1.8 Am, LL	BSL372SN 220 mΩ, 2.0 Am, LL			IRLML0100* 220 mΩ, 1.6 Am, LL		
	BSP373N 240 mΩ, 1.8 A, NL	BSL373SN 230 mΩ, 2.0 A, NL			BSS119N 6 Ω, 0.19 A, LL		
	BSP296N 600 mΩ, 1.2 Am, LL	BSL296SN 460 mΩ, 1.4 Am, LL			V _{GS(th)} 1.8 V ~ 2.3 V BSS123N 6 Ω, 0.19 A, LL		
200	BSP297 1.8 Ω, 0.66 A, LL				V _{GS(th)} 0.8 V ~ 1.8 V BSS169 12 Ω, 0.09 A, デプレッション		
	BSP149 3.5 Ω, 0.14 A, デプレッション						
240	BSP88 6 Ω, 0.35 A, 2.8 V 定格		BSS87 6 Ω, 0.26 A, LL		BSS131 14 Ω, 0.1 A, LL		
	BSP89 6 Ω, 0.35 A, LL						
250	BSP129 6 Ω, 0.05 A, デプレッション						
					BSS139 30 Ω, 0.03 A, デプレッション		
400	BSP298 3 Ω, 0.5 A, NL						
	BSP179 24 Ω, 0.04 A, デプレッション						
500	BSP324 25 Ω, 0.17 A, LL						
	BSP299 4 Ω, 0.4 A, NL						
600	BSP125 45 Ω, 0.12 A, LL		BSS225 45 Ω, 0.09 A, LL		BSS127 500 Ω, 0.023 A, LL		
	BSP135 60 Ω, 0.02 A, デプレッション				BSS126 700 Ω, 0.007 A, デプレッション		
800	BSP300 20 Ω, 0.19 A, NL						

www.infineon.com/smallsignal

全製品が自動車用 AEC Q101 に適合(2N7002を除く)(*付きの部品を除く)

¹⁾R_{DS(on)} 指定 4.5 V

P チャンネル パワー MOSFET



電圧 [V]	TO-252 (DPAK)	DirectFET™	SOT-23	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8	PQFN 2 x 2	TSOP-6
-20						BSO201SP H R _{DS(on)} =7.0 mΩ		
						BSO203SP H R _{DS(on)} =21.0 mΩ		
						BSO203P H R _{DS(on)} =21.0 mΩ		
				IRLML2244 ^{2) ***} R _{DS(on)} =54 mΩ			IRLHS2242TRPBF** R _{DS(on)} =31.0 mΩ	IRLTS2242 R _{DS(on)} =39 mΩ
				IRLML2246 ^{2) ***} R _{DS(on)} =135 mΩ			BSO207P H R _{DS(on)} =45.0 mΩ	
							BSO211P H R _{DS(on)} =67.0 mΩ	
-30	IPD042P03L3 G R _{DS(on)} =4.2 mΩ				BSC030P03NS3 G R _{DS(on)} =3.0 mΩ BSC060P03NS3E G R _{DS(on)} =6.0 mΩ; ESD	IRF9310 R _{DS(on)} =4.6 mΩ IRF9317 R _{DS(on)} =6.6 mΩ		
	SPD50P03L G ¹⁾ * R _{DS(on)} =7.0 mΩ	IRF9395M R _{DS(on)} =7.0 mΩ; デュアル		BSZ086P03NS3 G R _{DS(on)} =8.6 mΩ BSZ086P03NS3E G R _{DS(on)} =8.6 mΩ		IRF9321 R _{DS(on)} =7.2 mΩ BSO080P03NS 3 G R _{DS(on)} =8.0 mΩ		
					BSC084P03NS3 G R _{DS(on)} =8.4 mΩ BSC084P03NS3E G R _{DS(on)} =8.4 mΩ; ESD	BSO080P03NS3E G R _{DS(on)} =8.0 mΩ; ESD BSO080P03S H R _{DS(on)} =8.0 mΩ		
				BSZ120P03NS3 G R _{DS(on)} =12.0 mΩ BSZ120P03NS3E G R _{DS(on)} =12.0 mΩ; ESD		BSO301SP H R _{DS(on)} =8.0 mΩ IRF9328 R _{DS(on)} =11.9 mΩ IRF9388TRPBF R _{DS(on)} =11.9 mΩ BSO130P03S H R _{DS(on)} =13.0 mΩ		
						IRF9358 R _{DS(on)} =16 mΩ; デュアル		
				IRFHM9331 ²⁾ R _{DS(on)} =15 mΩ		IRF9332 R _{DS(on)} =17.5 mΩ IRF9392TRPBF R _{DS(on)} =17.5 mΩ		
				BSZ180P03NS3 G R _{DS(on)} =18.0 mΩ BSZ180P03NS3E G R _{DS(on)} =18.0 mΩ; ESD		IRF9333 R _{DS(on)} =19.4 mΩ BSO200P03S H R _{DS(on)} =20.0 mΩ		
						BSO303SP H R _{DS(on)} =21.0 mΩ BSO303P H R _{DS(on)} =21.0 mΩ; デュアル	IRFH9301TRPBF R _{DS(on)} =37.0 mΩ	
				IRLML9301TRPBF R _{DS(on)} =64 mΩ IRLML9303TRPBF R _{DS(on)} =165 mΩ		IRF9362 R _{DS(on)} =21 mΩ; デュアル	IRFHS9351TRPBF R _{DS(on)} =170.0 mΩ; デュアル	IRFTS9342*** R _{DS(on)} =32 mΩ
						IRF9335 R _{DS(on)} =59 mΩ		

¹⁾ 5 レッグ
²⁾ 2.5 V_{GS} 可能

* 自動車用 AEC Q101 適合製品
** R_{DS(on)} 指定 4.5 V
*** R_{DS(on)} 最大 @ V_{GS} =4.5 V



P チャネル パワー MOSFET



電圧 [V]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-220	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8
-60	IPD380P06NM $R_{DS(on)} = 38 \text{ m}\Omega$	IPB110P06LM $R_{DS(on)} = 11 \text{ m}\Omega$	SPP80P06P H* $R_{DS(on)} = 23.0 \text{ m}\Omega$			
	IPD650P06NM $R_{DS(on)} = 65 \text{ m}\Omega$	SPB80P06P G* $R_{DS(on)} = 23.0 \text{ m}\Omega$				
	SPD30P06P G* $R_{DS(on)} = 75.0 \text{ m}\Omega$					
	IPD900P06NM $R_{DS(on)} = 90 \text{ m}\Omega$					
	SPD18P06P G* $R_{DS(on)} = 130.0 \text{ m}\Omega$	SPB18P06P G* $R_{DS(on)} = 130.0 \text{ m}\Omega$	SPP18P06P H* $R_{DS(on)} = 130.0 \text{ m}\Omega$			BSO613SPV G* $R_{DS(on)} = 130.0 \text{ m}\Omega$
	SPD09P06PL G* $R_{DS(on)} = 250.0 \text{ m}\Omega$					
	IPD25DP06LM $R_{DS(on)} = 250 \text{ m}\Omega$					
	IPD25DP06NM $R_{DS(on)} = 250 \text{ m}\Omega$					
	SPD08P06P G* $R_{DS(on)} = 300.0 \text{ m}\Omega$	SPB08P06P G* $R_{DS(on)} = 300.0 \text{ m}\Omega$	SPP08P06P H* $R_{DS(on)} = 300.0 \text{ m}\Omega$			
	IPD40DP06NM $R_{DS(on)} = 400 \text{ m}\Omega$					
-100	SPD15P10PL G* $R_{DS(on)} = 200.0 \text{ m}\Omega$		SPP15P10PL H* $R_{DS(on)} = 200.0 \text{ m}\Omega$			
	SPD15P10P G* $R_{DS(on)} = 240.0 \text{ m}\Omega$		SPP15P10P H* $R_{DS(on)} = 240.0 \text{ m}\Omega$			
	SPD04P10PL G* $R_{DS(on)} = 850.0 \text{ m}\Omega$					
	SPD04P10P G* $R_{DS(on)} = 1000.0 \text{ m}\Omega$					

パワー MOSFET コンプリメンタリ



電圧 [V]	TO-252 (DPAK)	TO-263 (D ² PAK)	TO-220	PQFN 3.3 x 3.3	SuperSO8	SO-8
-20/20	>50 mΩ			BSZ15DC02KD H** N:55 mΩ, 5.1 A P:150 mΩ, -3.2 A BSZ215C H** N:55 mΩ, 5.1 A P:150 mΩ, -3.2 A		
-60/60	11-30 Ω					BSO612CV G* N:0.12 Ω, 3.0 A P:0.30 Ω, -2.0 A BSO615C G* N:0.11 Ω, 3.1 A P:0.30 Ω, -2.0 A

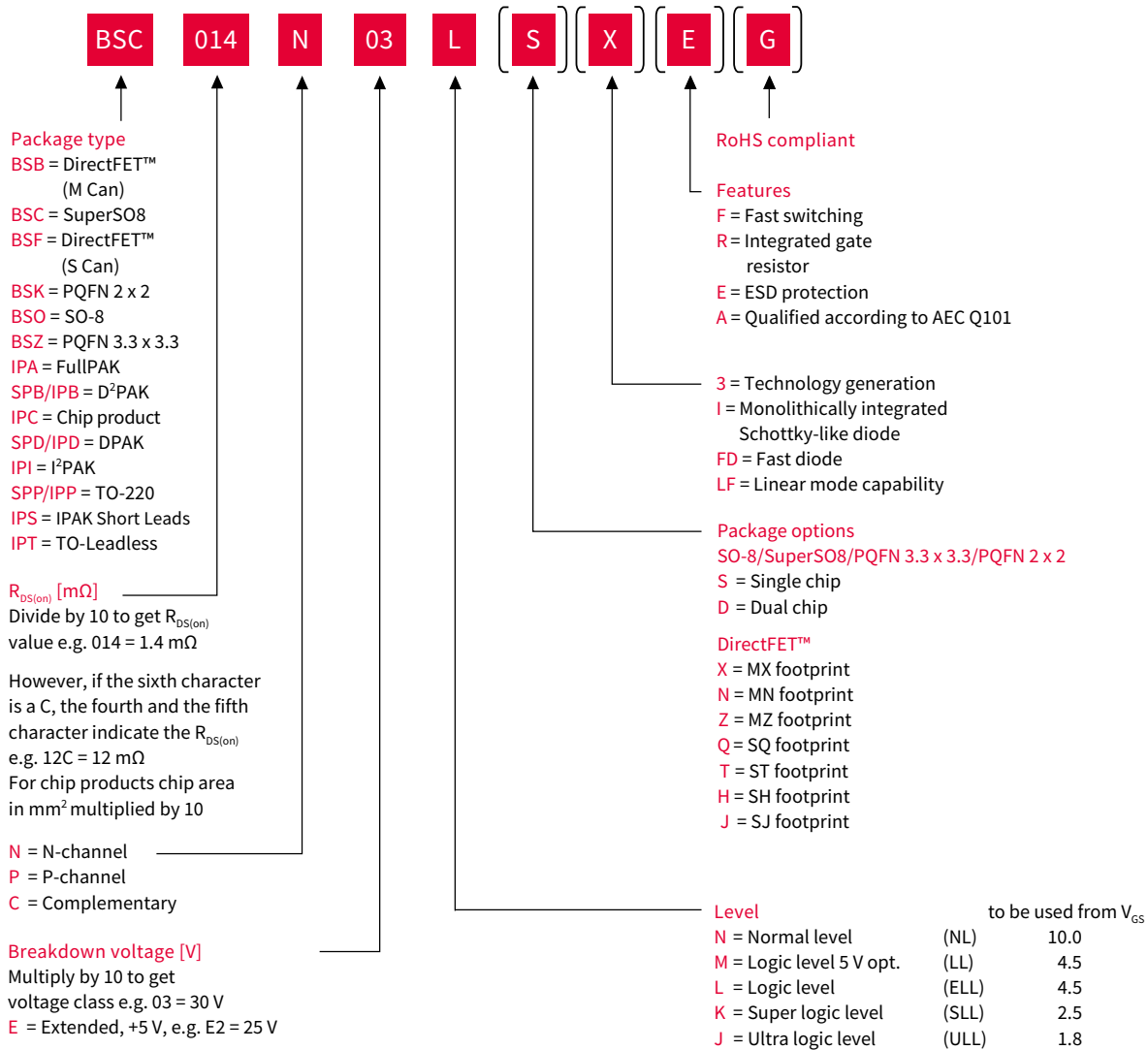
www.infineon.com/complementary

* 自動車用 AEC Q101 適合製品

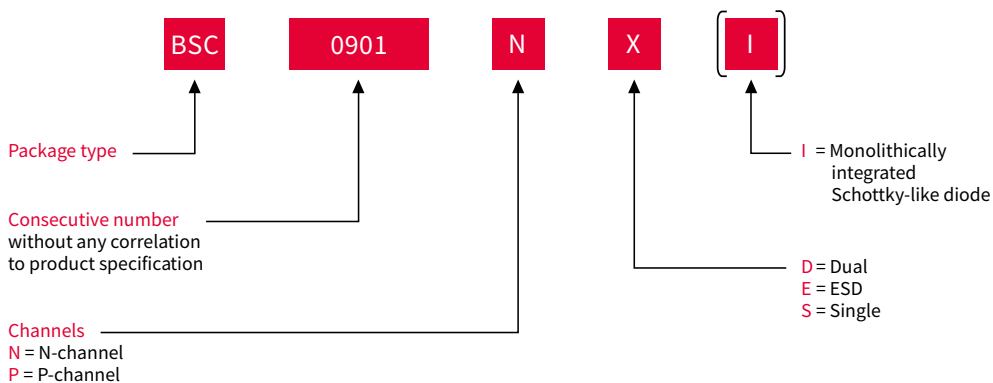
** $R_{DS(on)}$ 指定 4.5 V

製品番号の説明

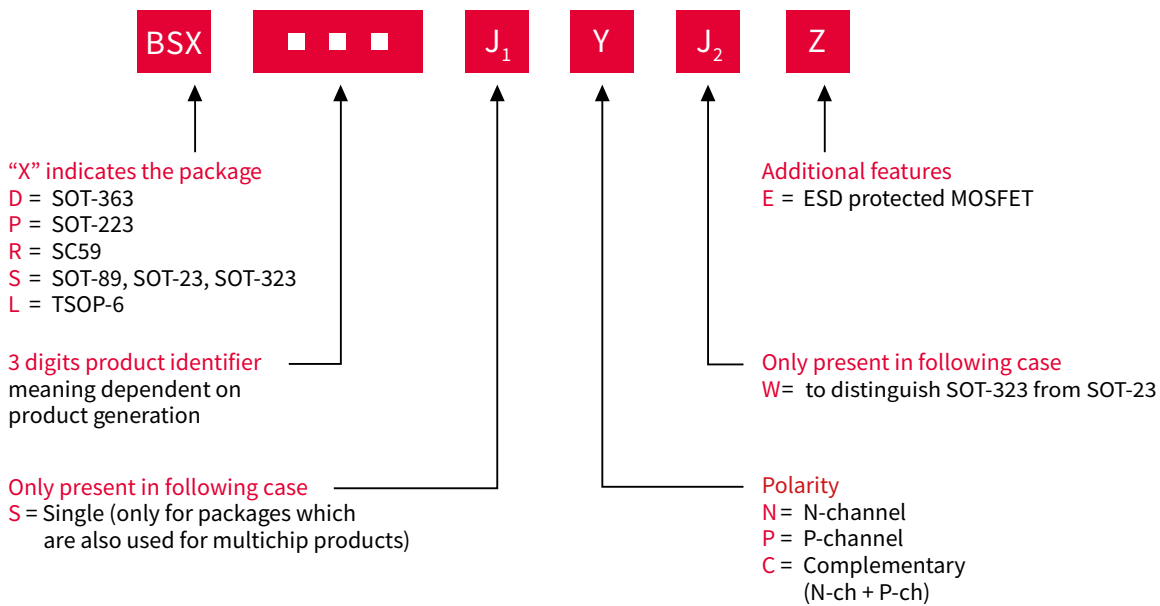
OptiMOS™



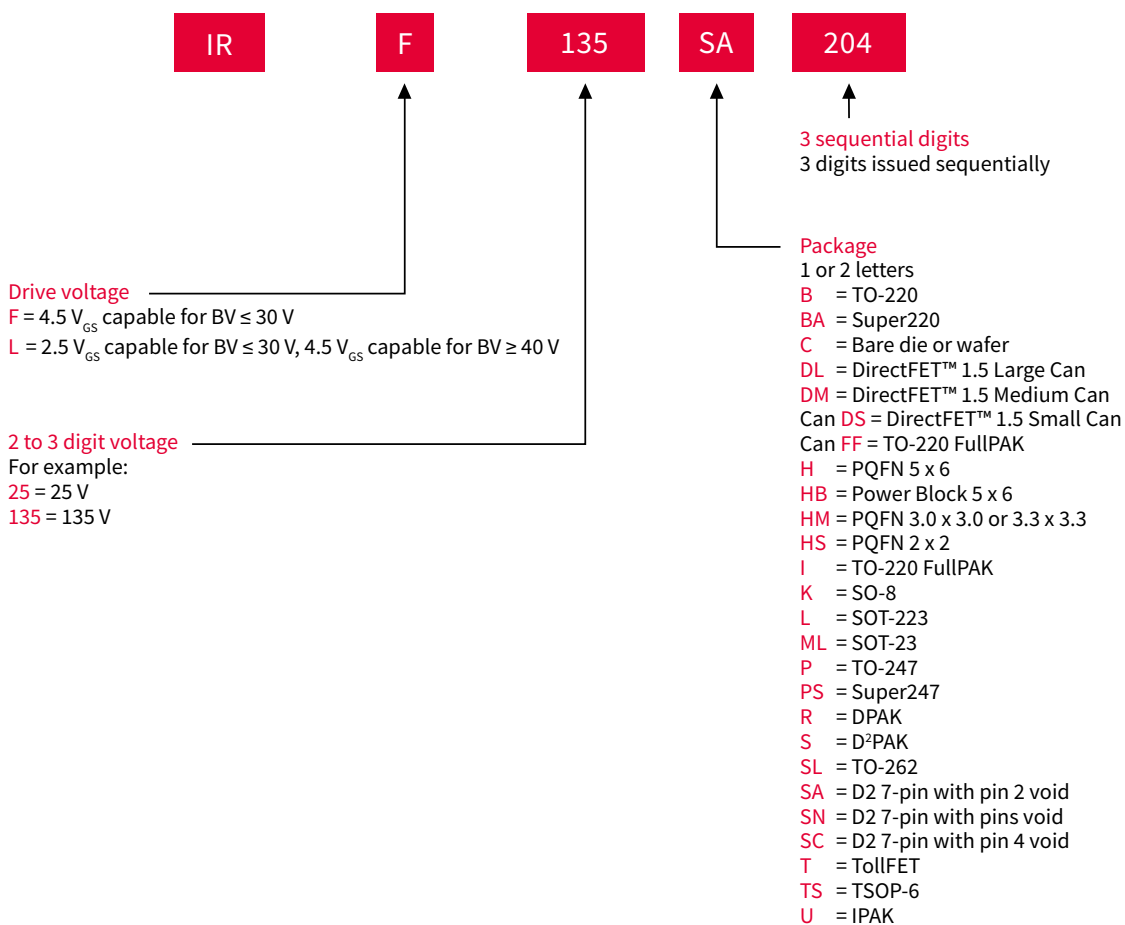
OptiMOS™ 30 V



小信号



StrongIRFET™(2015年5月以降)





Infineon support for low voltage MOSFETs

Useful links and helpful information

Further information, data sheets and documents

www.infineon.com/powermosfet-12V-300V

www.infineon.com/smallsignal

www.infineon.com/pchannel

www.infineon.com/depletion

www.infineon.com/complementary

www.infineon.com/baredie

Evaluation boards and simulation models

www.infineon.com/to-leadless-evaluationboard

www.infineon.com/powermosfet-simulationmodels

Videos

www.infineon.com/mediacenter





ゲートドライバ IC

すべてのスイッチにドライバが必要です

ゲートドライバ IC は、インフィニオンの MOSFET ポートフォリオを補完するソリューションです。インフィニオンのアプリケーション専門知識と高度な技術を活用した、産業用および汎用ゲートドライバ IC は、モータ駆動、太陽光発電用インバータ、UPS、スイッチモード電源など多くのアプリケーションに最適です。インフィニオンは、さまざまな構成、耐圧クラス、絶縁レベルおよびパッケージオプションを含む包括的なポートフォリオを提供しています。

当社のゲートドライバ IC ポートフォリオの詳細については、こちらをご覧ください。

www.infineon.com/gatedriver

www.infineon.com/eicedriver



A world leader
in semiconductor solutions



Our vision

We are the link between the
real and the digital world.

Our values

We commit
We partner
We innovate
We perform

Our mission

We make life
easier, safer
and greener.

Part of your life. Part of tomorrow.

購買について

インフィニオン販売代理店・営業所:
www.infineon.com/WhereToBuy

サービスホットライン

インフィニオンの年中無休の無料サービスホットライン 0800/4001 を 24 時間ご利用いただけます。

- › ドイツ 0800 951 951 951 (ドイツ語/英語)
- › 中国本土 4001 200 951 (北京語/英語)
- › インド 000 800 4402 951 (英語)
- › 米国 1-866 951 9519 (英語/ドイツ語)
- › その他の国 00* 800 951 951 951 (英語/ドイツ語)
- › 直通電話 +49 89 234-0 (通話料金制、ドイツ語/英語)

* ご注意:一部の国では、国際電話の利用に「00」以外のダイヤル番号が必要な場合もあります。
各国のwww.infineon.com/serviceをご覧ください。



モバイル製品カタログ
iOS および Android のモバイルアプリ。

www.infineon.com

Published by
Infineon Technologies Austria AG
9500 Villach, Austria

© 2019 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.

Order number: B131-I0828-V1-5A00-JP-EC-P
Date: 05/2019

Please note!

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND ANY INFORMATION GIVEN HEREIN SHALL IN NO EVENT BE REGARDED AS A WARRANTY, GUARANTEE OR DESCRIPTION OF ANY FUNCTIONALITY, CONDITIONS AND/OR QUALITY OF OUR PRODUCTS OR ANY SUITABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE. WITH REGARD TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF OUR PRODUCTS, WE KINDLY ASK YOU TO REFER TO THE RELEVANT PRODUCT DATA SHEETS PROVIDED BY US. OUR CUSTOMERS AND THEIR TECHNICAL DEPARTMENTS ARE REQUIRED TO EVALUATE THE SUITABILITY OF OUR PRODUCTS FOR THE INTENDED APPLICATION.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE THIS DOCUMENT AND/OR THE INFORMATION GIVEN HEREIN AT ANY TIME.

Additional information

For further information on technologies, our products, the application of our products, delivery terms and conditions and/or prices, please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, our products may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by us in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, our products may not be used in any life-endangering applications, including but not limited to medical, nuclear, military, life-critical or any other applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can result in personal injury.